

北京金诚同达律师事务所
关于
北京七星华创电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的法律意见书

金证法意[2016]字 0203 第 0022 号



金诚同达律师事务所

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004

电话：010-5706 8585

传真：010-8515 0267

目录

释义	2
一、本次重组的方案	7
二、本次重组相关各方的主体资格	15
三、本次重组的批准和授权	36
四、本次重组涉及的相关协议	39
五、本次重组涉及的标的资产	51
六、本次重组涉及的债权债务处理	79
七、关联交易和同业竞争	79
八、本次重组的实质条件	83
九、本次重组的信息披露	87
十、关于本次重组相关人员买卖证券行为的核查情况	88
十一、本次重组的证券服务机构	90
十二、结论意见	90

释义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义：

发行人/七星电子/上市公司/公司	指	北京七星华创电子股份有限公司
本次重组	指	七星电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，即七星电子通过发行股份的方式购买北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所等出售方合计持有的北方微电子 100% 股权，并向集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金非公开发行股份募集配套资金。
本次发行股份购买资产	指	七星电子向交易对方以发行股份方式购买交易对方合计持有的北方微电子 100% 的股权
本次募集配套资金	指	七星电子向集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额为 92,367.22 万元。
标的公司/北方微电子	指	北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司
标的资产/购入资产	指	交易对方合计持有的北方微电子 100% 股权，分别为北京电控持有的北方微电子 79.94% 股权，即 6,952.97 万元出资额；圆合电子持有的北方微电子 14.05% 股权，即 1,221.95 万元出资额；七星华电持有的北方微电子 3.14% 股权，即 272.94 万元出资额；中科院微电子所持有的北方微电子 2.88% 股权，即 250.40 万元出资额。
交易对方/出售方	指	北京电控、七星华电、圆合电子及中科院微电子所等 4 家法人
发行对象	指	集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金等 3 家机构
七星华电	指	北京七星华电科技集团有限责任公司
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司
中科院光电所	指	中国科学院光电技术研究所
北大宇环	指	北京北大宇环微电子系统有限公司
清华研究院	指	北京清华工业开发研究院
中科院微电子所	指	中国科学院微电子研究所（原名称为中国科学院微电子中心，于 2003 年 9 月更名）
圆合电子	指	北京圆合电子技术股份有限公司（原名称为北京圆合电子技术有限责任公司，于 2012 年 1 月 4 日更名）
集成电路产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司

芯动能基金	指	北京芯动能投资基金（有限合伙）
京国瑞基金	指	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
北京工投	指	北京工业发展投资管理有限公司
亦庄国投	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
吉乐集团	指	北京吉乐电子集团有限公司
硅元科电	指	北京硅元科电微电子技术有限责任公司
中国华融	指	中国华融资产管理公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011 年修订）
《第 26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》（2014 年修订）
《公司章程》	指	现行有效的《北京七星华创电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
《重组报告书》	指	《北京七星华创电子股份有限公司发股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《北方微电子审计报告》	指	《北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司审计报告》（编号：瑞华专审字[2015]01730061 号）
《评估报告》	指	《资产评估报告》（编号：北京亚超评报字[2015]第 A196 号）
《备考审计报告》	指	《北京七星华创电子股份有限公司备考审计报告》（编号：瑞华专审字[2015]01730063 号）
《盈利预测审核报告》	指	《北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司盈利

		预测审核报告》（编号：瑞华核字[2016]01730007 号）
审计基准日	指	2015 年 11 月 30 日
评估基准日	指	2015 年 11 月 30 日
定价基准日	指	七星电子第五届董事会第十四次会议审议通过本次重组相关议案之决议公告之日
交割日	指	标的资产过户至七星电子名下的股权变更登记之日
过渡期	指	评估基准日至标的资产交割日的期间
独立财务顾问/中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构/瑞华所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/亚超评估	指	北京亚超资产评估有限公司
本所	指	北京金诚同达律师事务所
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
元	指	人民币元

北京金诚同达律师事务所
关于北京七星华创电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
法律意见书

金证法意[2016]字 0203 第 0022 号

致：北京七星华创电子股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规和规范性文件的规定，本所受七星电子委托，作为七星电子向北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所非公开发行股份购买上述 4 家法人合计持有的北方微电子 100% 股权，并通过定价方式向集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金等 3 家机构非公开发行股份募集配套资金事宜的特聘专项法律顾问，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据现行法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重组所涉及的以下重大法律事项进行了核查：（1）本次重组的方案；（2）本次重组相关各方的主体资格；（3）本次重组的批准和授权；（4）本次重组涉及的相关协议；（5）本次重组涉及的标的资产；（6）本次重组涉及的债权债务处理；（7）关联交易和同业竞争；（8）本次重组的实质条件；（9）本次重组的信息披露；（10）本次重组各方及中介机构交易七星电子股票情况；（11）本次重组的主要中介机构。

七星电子、本次重组的交易对方和标的公司向本所保证，其已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并保证上述文件和证言真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；上述文件上所有签字与印章均为真实；上述副本材料或复印件均与原件一致。

对本所出具的法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。

2、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的其他事实，本所律师依赖于有关政府部门或其他单位出具的证明文件作出判断。

3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次重组有关内容的真实性、准确性和完整性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本法律意见书仅就本次重组的有关事项发表法律意见，而不对有关会计、审计、评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对其他中介机构出具的文件中有关数据和结论的援引，并不视为本所对该等数据和结论的真实性和准确性作出任何保证或确认。

5、本所同意七星电子按照中国证监会的有关规定在其为本次重组所制作的相关文件中部分或全部引用本法律意见书的内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

6、本所同意将本法律意见书作为本次重组所必备的法律文件，随其他材料一并上报，并依法对本所发表的法律意见承担相应的法律责任。

7、本法律意见书仅供七星电子本次重组之目的使用，未经本所同意，不得用于其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七星电子、交易对方和标的公司为本次重组提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次重组的方案

根据七星电子与交易对方于 2015 年 12 月 25 日签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，于 2016 年 2 月 3 日签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》；七星电子与发行对象分别于 2015 年 12 月 25 日签署的附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》，于 2016 年 2 月 3 日与芯动能基金签署的附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议》；七星电子于 2015 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议所作出的决议及会议审议通过的《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2016 年 2 月 3 日召开的第五届董事会第十五次会议所作出的决议及会议审议通过的《北京七星华创电子股份有限公司发行 A 股股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次重组方案的主要内容如下：

1、交易方案概要

七星电子拟通过发行股份方式购买交易对方合计持有的北方微电子 100% 股权，同时向发行对象非公开发行 A 股股票募集配套资金 92,367.22 万元。具体方式为：（1）公司收购北方微电子 100% 的股权所需支付对价为 92,367.22 万元，交易对价以向交易对方发行股份的方式支付，合计发行 52,811,444 股；（2）公司通过定价方式向发行对象非公开发行股份募集配套资金，用于北方微电子的在建项目“微电子装备扩产项目”建设及补充上市公司流动资金，募集配套资金总额为 92,367.22 万元，发行股份数量为 5,281.14 万股；（3）本次非公开发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

2、发行股份购买资产

（1）交易对方

本次重组的交易对方为北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所。

（2）交易标的

本次重组的交易标的为交易对方合计持有的北方微电子 100% 股权，分别为北京电控持有的北方微电子 79.94% 股权，即 6,952.97 万元出资额；圆合电子持有的北方微电子 14.05% 股权，即 1,221.95 万元出资额；七星华电持有的北方微电子 3.14% 股权，即 272.94 万元出资额；中科院微电子所持有的北方微电子 2.88% 股权，即 250.40 万元出资额。

（3）交易价格

本次重组交易价格以经北京市国资委核准的具有证券业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日进行评估确定的评估值为依据。根据亚超评估出具的《评估报告》，以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，北方微电子以成本法评估确认的股东全部权益价值为 92,367.22 万元，经交易各方友好协商，本次重组交易价格为 92,367.22 万元。

（4）发行价格与定价依据

根据《重组办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产所发行股份的价格选取公司董事会会议通过本次重组相关议案之决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格为 17.49 元/股，不低于七星电子董事会会议通过本次重组相关议案之决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行股份购买资产的股份发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

（5）发行数量

本次发行股份购买资产发行股份数量的计算公式为：发行数量=标的资产交易价格÷发行价格。据此计算，本次发行股份购买资产向交易对方合计发行 52,811,444 股。具体发行情况如下：

序号	发行对象	标的公司出资额 (万元)	持股比例 (%)	交易对价(万 元)	发行股份数 (股)
1	北京电控	6,952.97	79.94	73,833.91	42,214,926
2	圆合电子	1,221.95	14.05	12,975.94	7,419,063
3	七星华电	272.94	3.14	2,898.36	1,657,153
4	中科院微电子所	250.40	2.88	2,659.01	1,520,302
合计		8,698.26	100.00	92,367.22	52,811,444

交易对方所获得股份数不足 1 股的，发行股份时舍去不足 1 股部分后取整。
标的资产中价格不足 1 股的部分，由发行人无偿取得。

最终的发行数量将以购买资产成交价为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定，并以中国证监会最终核准的发行数量为准。

定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行股份购买资产的股份发行数量亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

(6) 锁定期安排

①北京电控自本次重组中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。自本次重组取得的上市公司股份中的 3,604,953 股自该等股份发行结束之日起 36 个月届满且北京电控履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。本次重组完成后，北京电控通过本次重组获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次重组发行价、或者交易完成后 6 个月期末上市公

公司股票收盘价低于本次重组发行价的，北京电控持有的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

②七星华电自本次重组中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。自本次重组取得的上市公司股份中的 136,594 股自该等股份发行结束之日起 36 个月届满且七星华电履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。本次重组完成后，七星华电通过本次重组获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次重组发行价、或者交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次重组发行价的，七星华电持有的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

③圆合电子自本次重组中取得的上市公司股份中的 6,807,534 股股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，圆合电子以北方微电子技术性无形资产组认购的 611,529 股股份，按以下安排分批解除限售：①自本次重组新增股份发行结束之日起十二个月届满且圆合电子履行完成 2016 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，155,396 股可解除限售；②自本次重组新增股份发行结束之日起二十四个月届满且圆合电子履行完成 2017 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，201,186 股可解除限售；③自本次重组新增股份发行结束之日起三十六个月届满且圆合电子履行完成 2018 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，254,947 股可解除限售。每次解除限售时，应待具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对北方微电子承诺营业收入实现情况出具《专项审核报告》后（其中第三次解锁需同时待北方微电子技术性无形资产组《减值测试报告》出具后），视是否需要按照《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协

议》实施补偿，在扣减需进行股份补偿部分后予以解锁相关股份。在上述股份解除限售之前，圆合电子保证该等股份不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次重组完成后，圆合电子通过本次重组获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。

④中科院微电子所自本次重组中取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起十二个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次重组完成后，中科院微电子所通过本次重组获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。

3、发行股份募集配套资金

（1）发行对象及认购方式

本次募集配套资金的发行对象为集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金等 3 家投资者，投资者以现金方式认购本次募集配套资金发行的股份。

（2）发行价格及定价依据

本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议通过本次重组相关议案之决议公告日。本次募集配套资金的发行价格为 17.49 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将按照证监会及深交所的相关规则作相应调整。

（3）发行数量

本次募集配套资金发行股份数量的计算公式为：发行数量=本次配套募集资金÷发行价格。据此计算，本次募集配套资金发行股份为 5,281.14 万股。具体发行情况如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	获得上市公司股份数（万股）
1	集成电路产业基金	60,000.00	3,430.53
2	芯动能基金	12,367.22	1,143.51
3	京国瑞基金	20,000.00	707.10
合计		92,367.22	5,281.14

按上述公式计算的股份数量，如出现不足 1 股的余额时，不足 1 股的舍去取整。

最终的发行数量将以募集配套资金总额、最终发行价格为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定。

定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次募集配套资金的股份发行数量亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

（4）募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资北方微电子的在建项目“微电子装备扩产项目”建设及补充上市公司流动资金，募集资金总额为 92,367.22 万元。补充流动资金比例不超过募集配套资金金额的 50%。实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司已使用自筹资金进行了先期项目投入，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关自筹资金。

经本所律师核查，“微电子装备扩产项目”已取得的批准文件情况如下：

2015 年 4 月 13 日，北京经济技术开发区管理委员会出具《关于北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司微电子装备扩产项目备案的通知》（编号：京技管项备字[2015]30 号），对该项目的可行性研究报告予以备案。

2015 年 7 月 6 日，北京经济技术开发区环境保护局出具《关于北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司微电子装备扩产项目环境影响报告表的批复》（编号：京技环审字[2015]157 号），同意该项目建设。

（5）锁定期安排

集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金在本次重组中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次重组完成后，集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金通过本次重组获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。

4、过渡期损益

自评估基准日起至标的资产交割日期间为过渡期，标的资产产生的期间收益由七星电子享有，标的资产产生的期间亏损由交易对方按本次交易完成前各自所持标的公司股权比例承担，并分别以现金方式向公司全额缴足，具体补偿金额以相关专项审计结果为基础计算。

5、上市地点

本次重组发行的股票拟在深交所上市。

6、上市公司滚存未分配利润安排

本次重组前七星电子产生的滚存未分配利润由本次重组后的新老股东共同享有。

7、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组（包括发行股份购买资产的股份发行和发行股份募集配套资金的股份发行）完成日。

8、本次重组构成重大资产重组

本次重组的标的资产为北方微电子 100%的股权，根据上市公司 2014 年的经审计的财务数据、标的公司报告期内经审计的财务数据和交易金额，本次交易的相关比例计算如下：

单位：万元

项目	七星电子	北方微电子	交易金额	计算依据	计算比例（%）
资产总额	388,615.96	114,841.88	92,367.22	114,841.88	29.55
资产净额	183,087.22	31,390.16	92,367.22	92,367.22	50.45
营业收入	96,173.41	26,608.38	-	26,608.38	27.67

根据上述测算，本次重组购买标的资产的预估值占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为 50.45%，且超过 5,000 万元人民币。根据《重组办法》，本次重组构成重大资产重组；同时本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易需要中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

9、本次重组构成关联交易

本次重组的交易对方中，北京电控为上市公司实际控制人，七星华电为七星电子控股股东，圆合电子为上市公司的关联方，根据相关法律、法规和《上市规则》的规定，本次重组构成关联交易。在七星电子召开的股东大会正式表决本次重组方案时，关联股东将回避表决。

10、本次重组不构成借壳上市

七星电子自上市之日起实际控制人未发生变更。在本次重组前，七星华电直接持有上市公司 50.12% 的股份，为上市公司的控股股东；北京电控持有七星华电 53.35% 的股权，为上市公司实际控制人；本次重组完成后，七星华电仍为公司的控股股东，北京电控直接持有上市公司 9.22% 的股份，通过七星华电间接持有上市公司 38.92% 的股份，合计持有上市公司 48.14% 的股份，仍为上市公司实际控制人。

按照标的资产的预估值 92,367.22 万元计算，本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东	发行前		发行后		
	持股数量 (万股)	占比	新增股数(万股)	持股数量 (万股)	占比

北京电控	--	--	4,221.49	4,221.49	9.22%
七星华电	17,651.57	50.12%	165.72	17,817.29	38.92%
北京电控及其关联方小计	17,651.57	50.12%	4,387.21	22,038.78	48.14%
圆合电子	--	--	741.91	741.91	1.62%
中科院微电子所	--	--	152.03	152.03	0.33%
集成电路产业基金	--	--	3,430.53	3,430.53	7.49%
京国瑞基金	--	--	1,143.51	1,143.51	2.50%
芯动能基金	--	--	707.10	707.10	1.54%
其他股东	17,568.43	49.88%	--	17,568.43	38.37%
总股本	35,220.00	100.00%	10,562.29	45,782.29	100.00%

本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。因此，本次重组不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市情形。

综上所述，本所律师认为，七星电子本次重组方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

二、本次重组相关各方的主体资格

本次重组主体包括股份发行人暨标的资产购买方七星电子、本次发行股份购买资产的交易对方暨标的资产的出售方北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所，以及本次募集配套资金所发行股份的认购方集成电路产业基金、芯动能基金、京国瑞基金。

（一）发行人主体资格

1、基本情况

根据七星电子现持有的《营业执照》、《公司章程》及在登记机关登记（备案）的企业信息并经本所律师核查，七星电子的登记（备案）情况如下：

公司名称	北京七星华创电子股份有限公司
统一社会信用代码	91110000726377528Y
法定代表人	张劲松
注册资本	35,220 万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
住所	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
经营范围	组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT 设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；销售集成电路设备、光伏设备、TFT 设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；技术咨询；技术开发；技术转让；经济贸易咨询；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2001 年 9 月 28 日
营业期限	永续经营
登记机关	北京市工商局
年报情况	2014 年度已公示
登记状态	在营（开业）企业

2、历史沿革

（1）七星电子设立

七星电子系经京政体改股函[2001]54号文《关于同意设立北京七星华创电子股份有限公司的通知》批准，由七星华电作为主发起人，联合吉乐集团、硅元科电、中国华融、自然人王荫桐和周凤英于2001年9月共同发起设立的股份有限公司。设立时其住所为北京市朝阳区酒仙桥东路1号，法定代表人为王东升，经营范围为“法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。”

2001年9月29日，中审会计师事务所出具《验资报告》，验证截至2001年9月25日止，发行人已收到全体发起人股东缴纳的注册资本合计为7,642万元。各发起人股东以净资产出资9,589.9万元，按1:0.75折股为7,192万元；货币出资600万元，按1:0.75折股450万元。七星电子设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	七星华电	40,120,000	52.50
2	吉乐集团	27,980,000	36.62
3	硅元科电	3,900,000	5.10
4	中国华融	3,820,000	5.00
5	王荫桐	300,000	0.39
6	周凤英	300,000	0.39
合计		76,420,000	100

（2）2005年4月，股份回购与减少注册资本

2005年4月11日，发行人召开2004年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购北京吉乐电子集团有限公司持有的36.62%股权的议案》，同意发行人以显示部品分公司经评估的资产净值5,146.14万元，回购吉乐集团持有的发行人2798万股股份并将其注销，每股的回购价格为1.8392元；发行人将回购股份注销后，注册资本由7,642万元减为4,844万元。

2005年4月26日，北京电控作出京电控投管字[2005]073号《关于北京七星华创电子股份有限公司回购北京吉乐电子集团有限公司持有的股份并减少注册资本的批复》，同意公司股东大会通过的回购预案，并对《北京七星华创电子股份有限公司显示部品分公司评估报告书》和《北京七星华创电子股份有限公司评估报告书》的评估结果予以备案。

2005年4月11日，吉乐集团与发行人签订《资产转让与回购股份之协议书》，就有关事项作出约定。

2005年7月22日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞华恒信验字[2005]第2024号《验资报告》，验证截至2005年5月31日，发行人注册资本减为4,844万元。其中，七星华电出资4,012万元，占注册资本的82.82%；硅元科电出资390万元，占注册资本的8.05%；中国华融出资382万元，占注册资本的7.89%；王荫桐、周凤英各出资30万元，各占注册资本的0.62%。

本次股份回购与减少注册资本完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	七星华电	40,120,000	82.82
2	硅元科电	3,900,000	8.05
3	中国华融	3,820,000	7.89
4	王荫桐	300,000	0.62
5	周凤英	300,000	0.62
合计		48,440,000	100

（3）2005年4月，周凤英向杨文良转让股份

2005年4月22日，公司发起人、副董事长周凤英与杨文良签订《股份转让协议》，双方约定周凤英将其持有的发行人的30万股份转让给杨文良，转让价格为55.2万元。

此次股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	七星华电	40,120,000	82.82
2	硅元科电	3,900,000	8.05
3	中国华融	3,820,000	7.89
4	王荫桐	300,000	0.62
5	杨文良	300,000	0.62
合计		48,440,000	100

（4）2006年6月，中国华融向硅元科电转让股份

2006年6月20日，中国华融与硅元科电签署《股权转让协议》，将其持有的公司7.89%的股份（计382万股），以893.38万元的价格转让给硅元科电。

此次股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	七星华电	40,120,000	82.82
2	硅元科电	7,720,000	15.94

3	王荫桐	300,000	0.62
4	杨文良	300,000	0.62
合计		48,440,000	100

(5) 2009年8月，杨文良向硅元科电转让股份

2009年8月16日，发行人召开2009年第一次临时股东大会，同意杨文良将其所持发行人30万股股份转让给硅元科电。

2009年8月1日，杨文良与硅元科电签订了《股份转让合同》，约定杨文良将其所持发行人30万股股权转让给硅元科电，转让价款为150.3万元。

此次股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	七星华电	40,120,000	82.82
2	硅元科电	8,020,000	16.56
3	王荫桐	300,000	0.62
合计		48,440,000	100

(6) 2010年3月，公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2010]186号文《关于核准北京七星华创电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深交所深证上[2010]84号文《关于北京七星华创电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，发行人公开发行1,656万股股票，其中首次上网定价公开发行的1,324.8万股普通股股票在深交所上市交易，证券简称为“七星电子”，证券代码为“002371”。

经北京市国资委京国资[2009]223号文《关于北京七星华创电子股份有限公司国有股转持的批复》批准，七星华电在上市前将其持有的七星电子165.6万股国有股划转给全国社会保障基金理事会。

2010年3月8日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第045号《验资报告》，验证截至2010年3月8日止，发行人注册资本变更为6,500万元。

此次公开发行并上市完成后，发行人的股权结构如下：

	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	七星华电	38,464,000	59.18
2	硅元科电	8,020,000	12.34
3	王荫桐	300,000	0.46
4	全国社会保障基金理事会	1,656,000	2.55
5	社会公众股股东	16,560,000	25.48
	合计	65,000,000	100

（7）2011年3月，限售股解禁

2011年3月16日，发行人股东硅元科电及王荫桐先生所持限售的2,305,000股，因自发行人股票上市之日起已满1年，解除限售。王荫桐先生于2010年9月25日辞去七星电子董事职务，本次解除限售后其持有的实际可上市流通数量为150,000股，占公司股本总额的0.23%。

本次解除限售后，发行人的股权结构如下：

股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股		
七星华电	38,464,000	59.18
硅元科电	6,015,000	9.25
王荫桐	300,000	0.46
全国社会保障基金理事会	1,656,000	2.55
二、无限售条件的流通股		
硅元科电	2,005,000	3.08
社会公众股股东	16,560,000	25.48
合计	65,000,000	100

（8）2011年7月，转增股本

经发行人2010年度股东大会审议通过，发行人以2010年年末总股本6,500万股为基数，每10股以资本公积金转增3股，并派发现金股利1元。转增完成后，

公司的总股本变更为8,450万股。

2011年7月12日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2011]第167号《验资报告》，验证截至2011年7月1日止，发行人注册资本变更为8,450万元。

本次转增股本完成后，发行人的股权结构如下：

股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股		
七星华电	50,003,200	59.18
硅元科电	7,819,500	9.25
王荫桐	195,000	0.23
全国社会保障基金理事会	2,152,800	2.55
二、无限售条件的流通股		
硅元科电	2,996,470	2.72
社会公众股股东	22,033,030	26.07
合计	84,500,000	100

（9）2012年3月，转增股本

经发行人2011年度股东大会审议通过，发行人以2011年年末总股本8,450万股为基数，每10股以资本公积金转增8股，并派发现金股利1元。转增完成后，公司的总股本变更为15,210万股。

2012年4月6日，中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2012]1012号《验资报告》，验证截至2012年3月27日止，发行人已将资本公积6,760万元转增股本，注册资本（累计股本）变更为15,210万元。

本次转增股本完成后，发行人的股权结构如下：

股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股		
七星华电	90,005,760	59.18

硅元科电	13,554,862	8.91
王荫桐	3,875,040	2.55
全国社会保障基金理事会		
二、无限售条件的流通股		
硅元科电	3,795,228	2.50
社会公众股股东	40,869,110	26.87
合计	152,100,000	100

(10) 2012年8月，非公开发行股票

经发行人2011年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2012]719号文《关于核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，发行人以非公开发行的方式发行股份2,400万股，发行价格为25.79元/股，认购金额为61,896.00万元。

2012年8月30日，中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2012]1029号《验资报告》，验证截至2012年8月30日止，发行人已收到投资者缴入的出资款61,896万元，注册资本（累计股本）变更为17,610万元。

本次非公开发行完成后，发行人的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股		
七星华电	90,005,760	51.11
硅元科电	13,554,862	7.70
北京市基础设施投资有限公司	9,000,000	5.11
全国社会保障基金理事会转持三户	3,875,040	2.20
宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	1.25
国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划	2,200,000	1.25
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,050,000	1.16
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	2,020,000	1.15
国君资管-建行-国泰君安君得增集合资产管理计划	2,000,000	1.15

兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	1,832,100	1.04
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	1,000,000	0.57
国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	800,000	0.45
浙商汇金大消费集合资产管理计划	380,000	0.22
兴业全球基金公司-兴业-陕西省国际信托股份有限公司	154,900	0.09
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	150,000	0.09
兴业全球基金公司-兴业-兴全特定策略6号特定多客户资产管理计划	116,200	0.07
兴业全球基金公司-交行-兴全特定策略7号特定多客户资产管理计划	96,800	0.05
二、无限售条件的流通股		
硅元科电	3,795,228	2.16
社会公众股股东	40,869,110	23.21
合计	176,100,000	100

(11) 2013 年 5 月，转增股本

经发行人 2012 年度股东大会审议通过，发行人以 2012 年年末总股本 17,610 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 10 股，并派发现金股利 1 元。转增完成后，公司的总股本变更为 35,220 万股。

2013年5月20日，中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2013]1034号《验资报告》，验证截至2013年5月10日止，发行人已将资本公积17,610万元转增股本，注册资本（累计股本）变更为35,220万元。

本次转增股本完成后，发行人的股权结构如下：

股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股		
硅元科电	25,847,386	7.34

二、无限售条件的流通股		
七星华电	176,515,720	50.12
硅元科电	2,124,482	0.60
社会公众股股东	147,712,412	41.94
合计	352,200,000	100

(12) 七星电子股权结构

截至 2015 年 11 月 30 日，公司股本总额为 35,220 万元，股权结构如下：

股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股		
硅元科电	14,756,769	4.19
二、无限售条件的流通股		
七星华电	176,515,720	50.12
硅元科电	1,201,925	0.34
其他股东	159,725,586	45.35
合计	352,200,000	100

截至 2015 年 11 月 30 日，七星电子的前 10 名股东持股情况如下：

股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
七星华电	176,515,720	50.12
硅元科电	15,958,694	4.53
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	11,859,002	3.37
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	8,887,914	2.52
中央汇金投资有限责任公司	8,749,300	2.48
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	7,101,050	2.02
全国社保基金一零九组合	6,800,000	1.93
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证	4,914,239	1.40

券投资基金		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	4,000,000	1.14
北京市基础设施投资有限公司	3,239,745	0.92

经核查，上述股东中，控股股东七星华电与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、本次重组的主体资格

根据七星电子提供的资料、七星电子《审计报告》并经本所律师核查，七星电子不存在下列不允许非公开发行股份的情形：

（1）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（2）上市公司的权益被控股股东和实际控制人严重损害且尚未消除；

（3）上市公司及附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（4）上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（5）上市公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

（7）严重损害投资者合法利益和社会公众利益。

经核查七星电子现行有效的公司章程、营业执照、工商登记（备案）资料，本所律师认为，七星电子为依法设立并合法存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，七星电子不存在根据法律、法规、规范性文件或其《公司章程》需要终止的情形，具备实施本次重组的主体资格。

（二）本次发行股份购买资产的交易对方的主体资格

1、北京电控

(1) 北京电控系本次重组的标的资产出售方之一，持有北方微电子 79.94% 的股权，出资额 6,952.97 万元。

(2) 根据北京电控现持有的《营业执照》、《公司章程》及在登记机关登记（备案）的企业信息并经本所律师核查，北京电控登记（备案）情况如下：

公司名称	北京电子控股有限责任公司
注册号	110000005099671
法定代表人	王岩
注册资本	130,737 万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
经营范围	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	1997 年 4 月 8 日
营业期限	至 2017 年 4 月 7 日
登记机关	北京市工商局
登记状态	在营（开业）企业

截至本法律意见书出具之日，北京电控的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京国有资本经营管理中心	130,737	100
合计		130,737	100

2、圆合电子

(1) 圆合电子系本次重组的标的资产出售方之一，持有北方微电子 14.05% 的股权，出资额 1,221.95 万元。

(2) 根据圆合电子现持有的《营业执照》、《公司章程》及在登记机关登记(备案)的企业信息并经本所律师核查,圆合电子登记(备案)情况如下:

公司名称	北京圆合电子技术股份有限公司
统一社会信用代码	91110302777088486D
法定代表人	赵坚
注册资本	940 万元
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所	北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 5B18 室
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
成立日期	2005 年 6 月 22 日
营业期限	至 2025 年 6 月 21 日
登记机关	北京市工商局开发区分局
登记状态	在营(开业)企业

截至本法律意见书出具之日,圆合电子的股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	耿锦启	450,000	4.79
2	赵晋荣	450,000	4.79
3	陶海虹	260,000	2.77
4	赵坚	240,000	2.55
5	邓向明	240,000	2.55
6	张建勇	230,000	2.45
7	李东三	230,000	2.45
8	李兵	230,000	2.45
9	王宝全	230,000	2.45
10	纪安宽	260,000	2.77
11	李秋林	200,000	2.13

12	任海霞	190,000	2.02
13	陈鹏	140,000	1.49
14	刘利坚	140,000	1.49
15	孙岩	190,000	2.02
16	白志民	140,000	1.49
17	赵梦欣	220,000	2.34
18	夏威	220,000	2.34
19	文东	190,000	2.02
20	付金生	130,000	1.38
21	苏二勇	100,000	1.06
22	孙亚林	100,000	1.06
23	杨威	100,000	1.06
24	夏凡	100,000	1.06
25	陆珏	90,000	0.96
26	李端林	100,000	1.06
27	霍秀敏	90,000	0.96
28	彭宇霖	190,000	2.02
29	胡谦	90,000	0.96
30	张玮	80,000	0.85
31	崔琳	80,000	0.85
32	张继宏	80,000	0.85
33	王铮	90,000	0.96
34	武小娟	80,000	0.85
35	荣延栋	80,000	0.85
36	苏晓峰	90,000	0.96
37	李娟娟	80,000	0.85
38	杨盟	210,000	2.23
39	杨洋	260,000	2.77
40	马宝林	80,000	0.85

41	魏小波	80,000	0.85
42	王春	60,000	0.64
43	王晶	50,000	0.53
44	张京华	50,000	0.53
45	李日曦	40,000	0.43
46	徐捷	40,000	0.43
47	李娜	50,000	0.53
48	温京彦	50,000	0.53
49	王娜	50,000	0.53
50	赵华	50,000	0.53
51	邢涛	40,000	0.43
52	胡立琼	40,000	0.43
53	潘宇涵	40,000	0.43
54	张宝辉	50,000	0.53
55	李谦	60,000	0.64
56	武晔	40,000	0.43
57	曹烁	30,000	0.32
58	梁小祎	30,000	0.32
59	马平	30,000	0.32
60	高建强	30,000	0.32
61	周洋	50,000	0.53
62	雷跃刚	30,000	0.32
63	陈庆	30,000	0.32
64	肖青平	30,000	0.32
65	韦刚	40,000	0.43
66	康明阳	30,000	0.32
67	刘美荣	40,000	0.43
68	蒋中伟	40,000	0.43
69	魏晓	30,000	0.32

70	温利	20,000	0.21
71	李跃	20,000	0.21
72	周游	20,000	0.21
73	徐惠海	20,000	0.21
74	刘岩	20,000	0.21
75	贾爽	20,000	0.21
76	相伟	15,000	0.16
77	宗令蓓	40,000	0.43
78	郭宁	15,000	0.16
79	谢秋实	20,000	0.21
80	张鹏	20,000	0.21
81	贾士亮	20,000	0.21
82	李璐	20,000	0.21
83	郑友山	20,000	0.21
84	李兴存	20,000	0.21
85	刘海鹰	15,000	0.16
86	吴鑫	15,000	0.16
87	栾大为	15,000	0.16
88	符雅丽	40,000	0.43
89	聂淼	20,000	0.21
90	李一成	30,000	0.32
91	王伟	15,000	0.16
92	成晓阳	15,000	0.16
93	宋瑞智	15,000	0.16
94	郑金果	30,000	0.32
95	边国栋	20,000	0.21
96	刘菲菲	20,000	0.21
97	董博宇	50,000	0.53
98	耿波	20,000	0.21

99	刘红义	15,000	0.16
100	文莉辉	15,000	0.16
101	余清	15,000	0.16
102	武学伟	15,000	0.16
103	邱国庆	15,000	0.16
104	叶华	15,000	0.16
105	杨玉杰	15,000	0.16
106	张彦召	15,000	0.16
107	刘建生	15,000	0.16
108	侯珏	15,000	0.16
109	李强	15,000	0.16
110	陈玉静	15,000	0.16
111	刘学庆	15,000	0.16
112	马志芳	130,000	1.38
113	方浩	20,000	0.21
114	赵海洋	20,000	0.21
115	袁福顺	20,000	0.21
116	刘悦	10,000	0.11
117	肖志刚	10,000	0.11
118	张吉初	10,000	0.11
119	梁晓乾	10,000	0.11
120	陆伟	50,000	0.53
121	吴文英	20,000	0.21
122	刘晨曦	15,000	0.16
123	白冰峰	20,000	0.21
124	韩建政	20,000	0.21
125	宋巧丽	40,000	0.43
126	王亚	30,000	0.32
127	谭宗良	20,000	0.21

128	李佳阳	20,000	0.21
129	牛昊	30,000	0.32
130	徐宪军	100,000	1.06
合计		9,400,000	100

3、七星华电

(1) 七星华电系本次重组的标的资产出售方之一，持有北方微电子 3.14% 的股权，出资额 272.94 万元。

(2) 根据七星华电现持有的《营业执照》、《公司章程》及在登记机关登记（备案）的企业信息并经本所律师核查，七星华电登记（备案）情况如下：

公司名称	北京七星华电科技集团有限责任公司
统一社会信用代码	91110000700224152G
法定代表人	王岩
注册资本	90,264.95 万元
公司类型	其他有限责任公司
住所	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
经营范围	制造电子材料、元器件、零部件、机电一体化设备、仪器仪表、电子产品、汽车电子产品；施工总承包、专业承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机动车公共停车场服务；研发及销售太阳能光伏产品；系统集成；光伏发电系统工程设计及咨询；项目投资；投资管理。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。）
成立日期	1999 年 6 月 10 日
营业期限	至 2029 年 6 月 9 日
登记机关	北京市工商局
登记状态	在营（开业）企业

截至本法律意见书出具之日，七星华电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
----	------	--------	---------

1	北京电控	481,582,310.38	53.35
2	中国华融	408,350,804.94	45.24
3	中国信达	12,716,527.13	1.41
合计		902,649,642.45	100

4、中科院微电子所

(1) 中科院微电子所系本次重组的标的资产出售方之一，持有北方微电子 2.88% 的股权，出资额 250.40 万元。

(2) 根据中科院微电子所现持有的《事业单位法人证书》及在登记机关登记（备案）的事业单位信息并经本所律师核查，中科院微电子所登记（备案）情况如下：

名称	中国科学院微电子研究所
证书号	事证第 110000000143 号
法定代表人	叶甜春
开办资金	15,200 万元
经费来源	财政补助、事业、经营收入
住所	北京市朝阳区北土城西路 3 号
宗旨和业务范围	开展微电子学与应用系统研究，促进科技创新。集成电路设计技术、工艺技术、封装技术、测试技术及设备研发微纳加工技术及产品研发功率器件、微波器件、传感器件技术及产品研发通讯与卫星导航定位系统芯片研发集成电路设计及知识产权共享服务相关学历教育、继续教育、专业培训与学术交流
举办单位	中国科学院
登记机关	国家事业单位登记管理局
有效期	2014 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

中科院微电子所系中国科学院举办的事业单位，截至本法律意见书出具之日，中科院微电子所其隶属关系未发生变化。

根据交易对方出具的声明及承诺函并经本所律师核查，本所律师认为，七星华电、北京电控、圆合电子、中科院微电子所系依法设立并合法存续的企业法人、

事业单位，不存在根据法律、行政法规、规范性文件以及章程规定需要终止、撤销的情形；具备参与本次重组的主体资格。

（三）本次募集配套资金所发行股份发行对象的主体资格

1、集成电路产业基金

根据集成电路产业基金现持有的《营业执照》、《公司章程》及在登记机关登记（备案）的企业信息并经本所律师核查，集成电路产业基金登记（备案）情况如下：

公司名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
注册号	100000000045238
法定代表人	王占甫
注册资本	9,872,000 万元
公司类型	股份有限公司（非上市）
住所	北京市市辖区经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室
经营范围	股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。
成立日期	2014 年 9 月 26 日
营业期限	2014 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日
登记机关	北京市工商局
登记状态	在营（开业）企业

经核查集成电路产业基金现行有效的公司章程、营业执照、工商登记（备案）资料，本所律师认为，集成电路产业基金为依法设立并合法存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，集成电路产业基金不存在根据法律、法规、规范性文件或其《公司章程》需要终止的情形；最近五年内，集成电路产业基金及其董事、监事、高级管理人员未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

集成电路产业基金属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的“私募投资

基金”，已于 2015 年 3 月 25 日完成私募投资基金备案，具备参与本次重组的主体资格。

2、芯动能基金

根据芯动能基金现持有的《营业执照》、《合伙协议》及在登记机关登记（备案）的企业信息并经本所律师核查，芯动能基金登记（备案）情况如下：

企业名称	北京芯动能投资基金（有限合伙）
注册号	1100000019730699
执行事务合伙人	北京益辰奇点投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 1 号楼 Q7 室
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品的交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2015 年 08 月 21 日
营业期限	2015 年 08 月 21 日至 2023 年 08 月 20 日
登记机关	北京市工商局
登记状态	在营（开业）企业

经核查芯动能基金现行有效的合伙协议、营业执照、工商登记（备案）资料，本所律师认为，芯动能基金为依法设立并合法存续的有限合伙企业，截至本法律意见书出具之日，芯动能基金不存在根据法律、法规、规范性文件或其《合伙协议》需要终止的情形；最近五年内，芯动能基金及其董事、监事、高级管理人员未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

芯动能基金属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的“私募投资基金”，已于 2015 年 12 月 8 日完成私募投资基金备案，具备参与本次重组的主体资格。

3、京国瑞基金

根据京国瑞基金现持有的《营业执照》、《合伙协议》及在登记机关登记（备案）的企业信息并经本所律师核查，京国瑞基金登记（备案）情况如下：

企业名称	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91110000MA0028CJ1L
执行事务合伙人	北京京国瑞投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
住所	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F805单元
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2015年07月07日
营业期限	2015年07月07日至2025年07月06日
登记机关	北京市工商局
登记状态	在营（开业）企业

经核查京国瑞基金现行有效的合伙协议、营业执照、工商登记（备案）资料，本所律师认为，京国瑞基金为依法设立并合法存续的有限合伙企业，截至本法律意见书出具之日，京国瑞基金不存在根据法律、法规、规范性文件或其《合伙协议》需要终止的情形；最近五年内，京国瑞基金及其董事、监事、高级管理人员未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

京国瑞基金属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的“私募投资基金”，其已向中国证券投资基金业协会提交私募投资基金备案的申请。

三、本次重组的批准和授权

（一）本次重组已取得的批准、授权及已履行的程序

截至本法律意见书出具之日，本次重组已取得的批准、授权及已履行的程序如下：

1、七星电子的批准和授权

2015年12月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于<北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>的议案》、《关于公司与北京芯动能投资基金（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>的议案》、《关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》等相关议案。

2016年2月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的标的资产交易价格及发行股份数量的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于<北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的

议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于公司与北京芯动能投资基金（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于本次重组审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》、《关于本次重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2、标的公司的批准和授权

2015 年 12 月 24 日，北方微电子召开 2015 年第五次临时股东会并作出决议，同意七星电子以发行股份的方式购买北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所等 4 家法人股东合计持有的北方微电子 100%股权。

3、交易对方的批准和授权

（1）2015 年 12 月 23 日，北京电控董事会作出决议同意参与本次重组。

（2）2015 年 12 月 15 日，圆合电子股东大会作出决议同意参与本次重组。

（3）2015 年 12 月 24 日，七星华电股东会作出决议同意参与本次重组。

（4）2015 年 12 月 22 日，中科院微电子所所务会作出决议同意参与本次重组。

（5）2015 年 12 月 22 日，京国瑞基金投资决策委员会作出决议同意参与本次重组。

（6）2015 年 12 月 24 日，芯动能基金投资决策委员会作出决议同意参与本次重组。

（7）集成电路产业基金已出具说明，说明其已履行内部决策程序同意参与本次重组。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次重组已履行了现阶段应当履行的批准或授权程序，所取得的相关批准和授权合法有效。

（二）本次重组尚需取得的批准、授权及履行的程序

根据有关法律法规和《发行股份购买资产协议》，本次重组尚需获得的批准程序如下：

- 1、本次重组获得发行人股东大会审议批准；
- 2、中国证监会核准本次重组方案。

四、本次重组涉及的相关协议

就本次重组涉及的发行股份购买资产事宜，七星电子与北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所于 2015 年 12 月 25 日签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、附生效条件的《盈利预测补偿协议》，于 2016 年 2 月 3 日签署了附生效条件的《发行股份购买资产之补充协议》、《盈利预测补偿之补充协议》。

就本次重组涉及的募集配套资金事宜，七星电子分别与集成电路产业基金、芯动能基金、京国瑞基金于 2015 年 12 月 25 日签署了附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》，于 2016 年 2 月 3 日与芯动能基金签署了附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议》。

（一）《发行股份购买资产协议》及补充协议

1、标的资产

交易对方合计持有的北方微电子 100% 股权，分别为北京电控持有的北方微电子 6,952.97 万元出资额；圆合电子持有的北方微电子 1,221.95 万元出资额；七星华电持有的北方微电子 272.94 万元出资额；中科院微电子所持有的北方微电子 250.40 万元出资额。

2、标的资产的定价依据及交易价格

交易双方同意并确认，标的资产的转让价格依据经北京市国资委核准的《资产评估报告》的评估值确定。2016年1月8日，北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京七星华创电子股份有限公司拟发行股份购买北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司全部股权资产评估项目予以核准的批复》（编号：京国资产权[2016]1号文），同意根据经核准的《资产评估报告》的评估值协商确定标的资产的转让价格。本次重组涉及相关税负由交易各方自行承担。

3、支付方式及发行价格、发行数量

本次发行股份购买资产交易价格以七星电子发行股份方式向交易对方支付，具体如下：

（1）发行股票种类、面值及对象

七星电子本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象为北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所，发行方式为非公开发行。

（2）发行价格

定价基准日为七星电子第五届董事会第十四次会议审议通过本次重组相关议案之决议公告之日。

七星电子向交易对方发行股份的价格为定价基准日前20个交易日七星电子股票交易均价的90%，即：发行价格=定价基准日前20个交易日七星电子股票交易总额÷定价基准日前20个交易日七星电子股票交易总量×90%，由此确定发行价格为17.49元/股，最终发行价格尚需经七星电子股东大会批准。

本次重组完成前公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），调整后的发行数量为 N_1 ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

除权、除息同时进行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

调整后的发行数量： $N_1 = \text{标的资产交易价格} \div P_1$

（3）发行数量

七星电子向交易对方发行股份数量的计算公式为：七星电子发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和；发行数量=交易对方各自所持标的资产交易价格 $\div$ 发行价格。

发行人向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位，标的资产中价格不足 1 股的部分，由发行人无偿获得。

本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

4、标的资产交付或过户

交易对方应在本协议生效后 15 个工作日内将其合计持有的北方微电子 100% 股权在公司登记主管部门过户至七星电子名下。七星电子应在标的资产在公司登记主管部门过户至七星电子名下后 15 个工作日内根据相关规定及时到中登公司为交易对方申请办理将本次向交易对方发行的股份登记在其名下的手续。

5、过渡期损益及滚存利润的归属

（1）在过渡期内，标的资产产生的期间收益由七星电子享有，标的资产产生的期间亏损由交易对方按各自在本次重组完成前所持标的公司股权比例承担并以现金方式向七星电子缴足，具体金额以相关专项审计结果为基础计算。

七星电子应聘请具有证券从业资格的审计机构对北方微电子在过渡期损益进行审计并出具专项审计报告。

(2) 在评估基准日之前,若标的资产及标的公司发生除资产评估机构所出具的评估报告中记载的债权债务之外的其他现实、或有负债,除经协议双方一致同意或另有约定外,该等未在评估报告中列明的现实、或有负债及与之相关的全部责任仍由交易对方承担。如上述其他现实、或有负债发生偿付时,标的公司可先行垫付,并向交易对方追偿。

(3) 过渡期间内,在未取得七星电子书面同意的情况下,交易对方保证标的公司不得 (i) 收购或者处置其核心财产;(ii) 财产、债务状况发生重大变化;(iii) 放弃或转让任何权利(包括债权、担保权益);(iv) 新签署重大合同,以及修改、变更或终止现有重大合同;(v) 对外提供任何贷款或担保;(vi) 承担负债或其他责任或放弃有关的权利;(vii) 合并、分立、增加或减少注册资本、清算;(viii) 向股东分配或派送任何股息、红利或其他收益;(ix) 其他可能对上市公司造成重大不利影响的事项。

(4) 七星电子在股份发行日前的滚存未分配利润,由发行后的新老股东共享。

6、标的公司债权债务处理及人员安排

(1) 本次重组的标的资产为北方微电子 100%的股权,北方微电子的独立法人地位并不因本次重组而改变,因此北方微电子仍将独立享有和承担其自身的债权和债务。

(2) 本次重组的标的资产为北方微电子 100%的股权,除协议约定事项外不涉及北方微电子的人员安置事项。北方微电子现有员工仍然与北方微电子保持劳动关系,并不因本次重组发生劳动关系的变更、解除或终止。

7、违约责任

(1) 本协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成违约,应就其违约行为使其他方遭受的全部损失承担赔偿责任

任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。

(2) 如果因法律法规或政策限制，或因七星电子股东大会未能审议通过，或因政府部门及/或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、深交所及中登公司）未能批准或核准本次发行股份购买资产，不视为任何一方违约。

8、生效条件及修改

协议自各方签字盖章之日起成立，自以下条件全部满足之日起生效：

(1) 七星电子按照法律法规和公司章程的规定获得其董事会、股东大会对本次重组的批准，交易对方就本次重组履行各自必要的内部审批程序；

(2) 本次重组获得中国证监会核准。

9、其他条款

《发行股份购买资产协议》还对不可抗力、适用法律及争议解决等内容作出了约定。

(二)《盈利预测补偿协议》及补充协议

1、利润承诺及补偿安排

(1) 本次重组中七星电子聘请瑞华所针对标的公司 2015 年 12 月及 2016 年度的盈利预测情况进行审计，并将出具《盈利预测审核报告》。

(2) 交易对方将以届时瑞华所出具的前述《盈利预测审核报告》中标的资产对应的 2016 年度盈利预测数为依据，向发行人承诺本次重组实施完毕后，标的公司 2016 年实现的净利润不低于《盈利预测审核报告》中列示的净利润预测数值。如果北方微电子 2016 年实际盈利未达到该净利润预测值，则交易对方须按照本协议约定以现金方式向发行人进行补偿。

2、利润补偿金额的确定

(1) 标的公司 2016 年度利润承诺及现金补偿安排

①根据瑞华所针对标的公司 2015 年 12 月及 2016 年度的盈利预测情况进行审计，并出具的《盈利预测审核报告》，同意标的资产 2016 年度预测净利润为 6,317.05 万元。

②交易对方承诺本次交易实施完毕后，标的公司 2016 年实现的净利润不低于 6,317.05 万元。如果北方微电子 2016 年实际盈利未达到该净利润预测值，则出售方须按照《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议》约定的方式向发行人进行补偿。

③若标的公司 2016 年实现的经审计实际净利润低于承诺净利润，则交易对方依据以下方式计算应向发行人补偿的现金：

应补偿现金金额=（业绩承诺期承诺净利润－业绩承诺期实际净利润）×交易对方本次交易完成前各自在北方微电子的持股比例

发行人应在 2016 年度专项审核报告披露后的 15 个工作日内，书面通知交易对方向发行人支付应补偿的现金金额。交易对方应在收到通知之日起 15 个工作日内向发行人支付应补偿的现金金额。

（2）标的公司技术性无形资产组估值的盈利预测补偿安排

①技术性无形资产组评估情况

根据亚超评估对本次交易出具的《评估报告》，截至评估基准日 2015 年 11 月 30 日，标的公司 100%股东权益评估价值为 92,367.22 万元，该评估结果已经北京市国资委核准。

根据上述评估报告，标的资产估值采用了资产基础法的评估结论，在资产基础法评估过程中，对投资转入的非专利技术、专利技术、专利申请（已受理尚未授权的专利技术）和软件著作权等技术性无形资产（以下简称“技术性无形资产组”）采用收益法进行了评估，评估值为 7,613.53 万元。技术性无形资产组的评估值按其对于北方微电子营业收入的贡献折成现值来计算，根据《评估报告》，预计北方微电子 2016 年实现营业收入 50,927.35 万元、2017 年实现营业收入 65,934.19 万元，2018 年实现营业收入 83,553.21 万元。

因技术性无形资产组采用了收益法评估结果且该等评估结果作为相关资产定价依据，根据中国证监会相关规定，交易对方应对上述用收益法评估结果作为定价依据的技术性无形资产组进行业绩承诺。

经商定，交易对方同意对标的公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度（以下简称“技术性无形资产组业绩承诺期”、“业绩承诺期”）的业绩进行承诺并作出可行的补偿安排。

②承诺营业收入情况

交易对方承诺：本次交易完成后，北方微电子 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除本次交易配套募集资金投入产生的效益后实现的营业收入应分别不低于 50,927.35 万元、65,934.19 万元和 83,553.21 万元。

北方微电子的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，并与上市公司会计政策及会计估计不存在重大差异。除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则业绩承诺期内，未经上市公司董事会批准，北方微电子不得改变其会计政策及会计估计。

③业绩承诺差额的确定

各方一致确认，本次交易实施完毕后，北方微电子应在 2016 年、2017 年、2018 年的会计年度结束时，由发行人聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对其实际营业收入与同期承诺营业收入的差额情况进行审核并出具专项审核报告。

若标的公司在业绩承诺期内的实际营业收入不足承诺营业收入，就其差额部分，交易对方应进行补偿。

④业绩承诺补偿方式及数额

业绩承诺期的每一会计年度结束后，发行人应聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，北方微电子的

承诺营业收入与实际营业收入的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。

本次交易完成后，在业绩承诺期内，交易对方承诺若标的公司在业绩承诺期内各年度末累积实际营业收入不足累积承诺营业收入的，发行人以总价人民币 1.00 元向交易对方回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为 4,353,076 股。该回购股份上限的计算公式为：本次交易中交易对方出售标的资产获得的上市公司股份数（52,811,444 股） $\times$ 7,613.53 万元/92,367.22 万元。

业绩承诺期内，北方微电子截至当期期末累积实际营业收入低于截至当期期末累积承诺营业收入的，交易对方应当以股份对上市公司进行补偿。当年股份应补偿数 = $\{(\text{截至当期期末累积承诺营业收入} - \text{截至当期期末累积实际营业收入}) \div \text{补偿期限内各年的承诺营业收入总和}\} \times 4,353,076 \text{ 股} - \text{已补偿股份数量}$ 。

如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数 = 当年应补偿的股份数 $\times$ (1 + 转增或送股比例)。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。

交易对方在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时，按 0 计算，即已经补偿的股份不冲回。

交易对方应补偿的股份由上市公司以总价人民币 1.00 元回购并注销，上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知交易对方，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由交易对方将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除交易对方之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的

股份数（不包括七星华电在本次交易前已持有上市公司的股份）后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。

⑤减值测试及补偿措施

在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构对北方微电子上述技术性无形资产组进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时技术性无形资产组的资产范围应与本次交易评估时的资产范围完全一致，不考虑本次交易后北方微电子新增无形资产的情况。

如果北方微电子上述技术性无形资产组期末减值额>交易对方补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则交易对方另行对上市公司进行股份补偿，应补偿股份数=（期末减值额-在业绩承诺期内因累积实际营业收入不足累积承诺营业收入已支付的补偿额）÷本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。

在任何情况下，因北方微电子技术性无形资产组减值而发生的股份补偿和因实际营业收入不足承诺营业收入而发生的股份补偿合计不超过 4,353,076 股。

⑥补偿义务的承担

交易对方同意，交易对方各方在本协议项下的标的公司技术性无形资产组估值盈利预测补偿义务份额应根据本次交易完成前各自在北方微电子的出资比例来计算。

中科院微电子所在本协议项下的标的公司技术性无形资产组估值盈利预测补偿义务由北京电控代为承担。

3、补偿的实施

业绩承诺期届满，七星电子应在年度专项审核报告披露后的 15 个工作日内，书面通知交易对方向七星电子支付应补偿的现金金额。交易对方应在收到通知之日起 15 个工作日内向七星电子支付应补偿的现金金额。

4、协议的生效及修改

(1) 本协议自下列条件全部满足后生效：七星电子与交易对方签署的《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产协议》已生效、本次重组依法实施完毕。

(2) 任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补充文件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为准。

(三) 发行人与发行对象分别签署的《股份认购协议》及补充协议

1、发行股票的种类和面值

本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行方式和发行对象

采用非公开发行的方式，发行对象为集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金。

3、发行价格

定价基准日为七星电子第五届董事会第十四次会议审议通过本次重组相关议案之决议公告之日。

七星电子向发行对象发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日七星电子股票交易均价的 90%，即：发行价格=定价基准日前 20 个交易日七星电子股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日七星电子股票交易总量×90%，由此确定发行价格为 17.49 元/股，最终发行价格尚需经七星电子股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，如果发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应按照深交所等证券监管机构规范的交易规则相应调整。

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），调整后的发行数量 N_1 ，则：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P_1 = P_0 \div (1 + N)$$

$$\text{除权、除息同时进行： } P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$$

$$\text{调整后的发行数量： } N_1 = \text{募集配套资金} \div P_1$$

4、发行数量

本次募集配套资金为 92,367.22 万元，七星电子向集成电路产业基金、芯动能基金、京国瑞基金发行股份数量合计为 52,811,445 股，募集配套资金的股份发行数量具体情况如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	获得上市公司股份数（万股）
1	集成电路产业基金	60,000.00	3,430.53
2	芯动能基金	13,084.19	1,143.51
3	京国瑞基金	20,000.00	707.10
合计		92,367.22	5,281.14

最终发行数量将由七星电子董事会提请股东大会授权并根据中国证监会核准的股数为准。发行人向上述各方发行股份数量应精确至个位，不足一股的舍去取整。

5、上市地点

本次募集配套资金项下非公开发行的股票拟在深交所上市。

6、锁定期安排

（1）集成电路产业基金、芯动能基金、京国瑞基金认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有

关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的,上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。

(2) 本次非公开发行结束后,发行对象通过本次认购持有的发行人股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守上述股份限售安排。

7、认购方式

集成电路产业基金、芯动能基金、京国瑞基金以货币资金作为支付对价认购。

8、滚存未分配利润安排

发行人在交易完成日前的滚存未分配利润,经发行人股东大会审议批准本次重组后,由本次重组完成后上市公司的新老股东共同享有。

9、募集资金用途

本次重组募集的配套资金将用于北方微电子“微电子装备扩产项目”建设及补充七星电子流动资金。

10、认购股份对价支付及新增股份的交付

在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后,各发行对象应按发行人与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期,并在收到发行人发出的认缴股款缴纳通知 5 个工作日内,按照通知要求以现金方式将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所专门开立的账户。在各发行对象将认股资金交付发行人指定账户后 15 个工作日内,发行人应向中登公司提交各发行对象现金认购股份的股票登记申请文件。发行人适时于工商管理部门办理注册资本变更、章程备案手续。

11、协议生效及终止

发行人与各发行对象签署协议的生效条件如下:

(1) 发行人与集成电路产业基金签署的《股份认购协议》生效条件为:

①集成电路产业基金内部有权决策机构审议批准认购发行人本次非公开发行股份，并认可发行人非公开发行股份募集配套资金的方案；

②本次重组获得发行人董事会、股东大会审议批准；

③中国证监会核准本次重组方案。

（2）发行人与芯动能基金签署的《股份认购协议》生效条件为：

①本次重组获得发行人董事会、股东大会审议批准；

②中国证监会核准本次重组方案。

（3）发行人与京国瑞基金签署的《股份认购协议》生效条件为：

①本次重组获得发行人董事会、股东大会审议批准；

②中国证监会核准本次重组方案。

发行人与各发行对象签署的《股份认购协议》的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但募集配套资金的实施或成功与否并不影响本次发行股份购买资产交易的生效和实施。

综上所述，本所律师认为，上述协议具有法律、法规和规范性文件所规定的必备条款，内容合法，在约定的生效条件成就时生效，对协议各方具有法律约束力。

五、本次重组涉及的标的资产

本次重组中，七星电子将受让的标的资产为北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所等 4 家法人股东合计持有北方微电子 100%的股权，其中受让北京电控持有的北方微电子 79.94%的股权、圆合电子持有的北方微电子 14.05%的股权、七星华电持有的北方微电子 3.14%股权、中科院微电子所持有的北方微电子 2.88%的股权。标的资产北方微电子的主要情况如下：

（一）基本情况

根据北京市工商局开发区分局于 2016 年 1 月 26 日核发的《营业执照》及北方微电子在登记机关登记（备案）的企业信息并经本所律师核查，北方微电子登记（备案）情况如下：

公司名称	北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司
统一社会信用代码	91110302801786752A
法定代表人	王岩
注册资本	8,698.26 万元
公司类型	其他有限责任公司
住所	北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号
经营范围	生产太阳能电池片、LED 衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2001 年 10 月 25 日
营业期限	至 2021 年 10 月 24 日
登记机关	北京市工商局开发区分局
登记状态	在营（开业）企业

经核查，截至本法律意见书出具之日，北方微电子的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	6,952.97	74.94
2	圆合电子	1,221.95	14.05
3	七星华电	272.94	3.14
4	中科院微电子所	250.40	2.88
	合计	8,698.26	100

（二）设立及股权演变

1、北方微电子的设立

2001 年 9 月 7 日，北京市工商局出具《企业名称预先核准通知书》（编号：

[京]企名预核[内]字[2001]第 10533852 号), 同意公司名称为“北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司”, 该预先核准的企业名称保留期自 2001 年 9 月 7 日至 2002 年 3 月 6 日。

2001 年 8 月 29 日, 北京电控、七星华电、清华研究院、北大宇环、中科院微电子所、中科院光电子所共同签署《北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司章程》。

2001 年 10 月 18 日, 北京华益会计师事务所有限责任公司出具《开业登记验资报告书》(编号: [2001]华益验[c]字第 212 号)。经该验资机构审验, 公司股东各方认缴出资的 1,000 万元注册资金, 已按公司章程的有关规定将出资款全部缴足。

2001 年 10 月 25 日, 北京市工商局核发《企业法人营业执照》(注册号: 1101051335268), 公司登记(备案)情况如下:

公司名称	北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司
注册号	1101051335268
法定代表人	张伯旭
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
住所	北京市朝阳区酒仙桥万红路 1 号
经营范围	微电子设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训; 销售: 五金交电、机械设备、电气设备、仪器仪表(未取得专项许可的项目除外)。
成立日期	2001 年 10 月 25 日
营业期限	至 2021 年 10 月 24 日
登记机关	北京市工商局

北方微电子设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京电控	800	80
2	七星华电	120	12

3	清华研究院	20	2
4	北大宇环	20	2
5	中科院微电子所	20	2
6	中科院光电所	20	2
	合计	1,000	100

本所律师认为，北方微电子的设立过程符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、2005 年 7 月，第一次增资扩股

2005 年 5 月 31 日，北京电控出具《关于同意北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限公司增资扩股的批复》（编号：京电控投管字[2005]100 号），同意北方微电子管理和技术团队个人以现金、海外技术专家以技术出资组建高技术公司。

2005 年 6 月 8 日，北京市工业促进局出具《关于同意北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司增资扩股的批复》，同意北京电控报送的关于北方微电子增资扩股方案。

2005 年 7 月 22 日，北方微电子召开 2005 年第一次股东会并作出决议，一致同意增加圆合电子以非专利技术向公司出资 538 万元，增资后公司注册资本由 1,000 万元增至 1,538 万元。

2005 年 7 月 22 日，北京今创会计师事务所出具《评估报告书》（编号：京创会评字[2005]第 1035 号）。经该评估机构确认，圆合电子拟投资于北方微电子的“集群设备传输平台”评估价值为 610.89 万元。

2005 年 7 月 29 日，中审会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》（编号：中审评报字[2005]第 5050 号）。经该评估机构确认，截至 2014 年 12 月 31 日，北方微电子净资产评估值为 1,000.12 万元。该评估结果已办理国有资产评估项目备案。

北京电控、七星华电、清华研究院、北大宇环、中科院微电子所、中科院光电所、圆合电子共同签署《非专利技术确认书》，确认圆合电子拥有的“集群设

备传输平台”非专利技术经评估确认评估值为 610.89 万元，同意将该非专利技术投入北方微电子，同意将评估值与出资额的差额 72.89 万元计入北方微电子资本公积。

2005 年 8 月 4 日，北京联首会计师事务所出具《企业实物转移专项审计报告》（编号：联首专审字[2005]第 018 号）。经该审计机构审核，上述非专利技术资产投资已办理了财产转移手续，已计入公司会计账目并反映在资产负债表中。

经核查，本所律师发现本次技术出资比例占公司注册资本比例 34.98%。2004 年施行的《公司法》第 24 条规定“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”，2001 年施行的《北京市中关村科技园区企业登记注册管理办法》第 13 条规定“以高新技术成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制，由出资人在企业章程中约定。企业注册资本（金）中以高新技术成果出资的，对高新技术成果应当经法定评估机构评估”。第 14 条规定“出资人以高新技术成果出资，应当出具高新技术成果说明书；该项高新技术成果应当由企业的全体出资人一致确认，并应当在章程中写明。经全体出资人确认的高新技术成果可以作为注册资本（金）登记注册”。本所律师查阅了中国电子专用设备工业协会作出的《关于集群设备市场分析意见的说明》、中国真空学会作出的《关于集群设备传输平台的技术评价》、北京半导体行业协会作出的《集群设备传输平台技术评审意见》，本所律师认为该技术出资比例符合上述法律、规范性文件的规定。此外，本次出资未经会计师事务所出具《验资报告》。经核查，本所律师认为，本次出资虽未出具验资报告，但经会计师事务所出具专项审计报告，鉴证了技术出资已办理财产转移手续并计入会计账目及反映在资产负债表中。据此，本所律师认为，本次技术出资对本次发行不存在法律障碍。

本次增资扩股完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	800	52.02
2	圆合电子	538	34.98

3	七星华电	120	7.80
4	清华研究院	20	1.30
5	北大宇环	20	1.30
6	中科院微电子所	20	1.30
7	中科院光电所	20	1.30
	合计	1,538	100

3、2008 年 9 月，第二次增资扩股

2008 年 5 月，中水资产评估有限公司出具《北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告书》（编号：中水评报字[2008]第 1004 号）。经该评估机构确认，截至 2007 年 12 月 31 日北方微电子净资产评估值为 8,003.02 万元。

2008 年 9 月 25 日，北方微电子召开 2008 年第一次股东会并作出决议，一致同意北京电控、中科院微电子所、北京工投共同对公司增资合计 666.85 万元，增资后公司注册资本由 1,538 万元增至 2,204.85 万元。

2008 年 10 月 15 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于对北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司增资扩股项目资产评估项目予以核准的批复》（编号：京国资[2008]299 号），同意对本次北方微电子增资扩股资产评估项目予以核准。

2009 年 4 月 13 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（编号：中喜验字[2009]第 01014 号）。经该验资机构审验，截至 2009 年 4 月 13 日，公司已收到北京电控、中科院微电子所、北京工投缴纳新增注册资本（实收资本）合计 668.5 万元，均为货币出资。其中北京电控缴纳 384.35 万元，中科院微电子所缴纳 90.32 万元，北京工投缴纳 192.18 万元。变更后的公司注册资本为 2,204.85 万元。

本次增资扩股完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	1,184.35	53.72

2	圆合电子	538	24.40
3	北京工投	192.18	8.73
4	七星华电	120	5.45
5	中科院微电子所	110.32	5.00
6	北大宇环	20	0.90
7	清华研究院	20	0.90
8	中科院光电所	20	0.90
	合计	2,204.85	100

4、2008 年 9 月，资本公积金转增股本

2008 年 9 月 25 日，北方微电子召开 2008 年第二次股东会并作出决议，一致同意公司以资本公积金 2,803.15 万元转增注册资本，增资后注册资本由 2204.85 万元增至 5,008 万元。

2009 年 5 月 11 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（编号：中喜验字[2009]第 01017 号）。经该验资机构审验，截至 2009 年 5 月 11 日，公司已将资本公积金 2,803.15 万元转增股本，变更后公司累计注册资本（实收资本）为 5,800 万元。

本次资本公积金转增股本完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	2,690.30	53.72
2	圆合电子	1,221.95	24.40
3	北京工投	437.20	8.73
4	七星华电	272.94	5.45
5	中科院微电子所	250.40	5.00
6	北大宇环	45.07	0.90
7	清华研究院	45.07	0.90
8	中科院光电所	45.07	0.90
	合计	5,008	100

5、2010 年 4 月，第三次增资扩股

2009 年 12 月 15 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《北京电子控股有限责任公司拟对北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司增资扩股项目资产评估报告书》（编号：天兴评报字[2009]第 492 号）。经该评估机构确认，截至 2009 年 10 月 31 日北方微电子净资产评估值为 23,377.79 万元。

2010 年 4 月 23 日，北方微电子召开 2010 年第一次股东会并作出决议，一致同意北京电控、亦庄国投对公司增资合计 2,783.72 万元，增资后公司注册资本由 5,008 万元增至 7,791.72 万元。

2010 年 4 月 27 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司增资扩股评估项目予以核准的批复》（编号：京国资产权[2010]63 号），同意对本次北方微电子增资扩股资产评估项目予以核准。

2010 年 9 月 17 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（编号：中喜验字[2010]第 01047 号）。经该验资机构审验，截至 2010 年 9 月 17 日，公司已收到北京电控、亦庄国投缴纳新增注册资本（实收资本）合计 2,783.72 万元，均为货币出资。其中北京电控缴纳 214.13 万元，亦庄国投缴纳 2,569.59 万元。变更后公司注册资本为 7,791.72 万元。

本次增资扩股完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	2,690.30	37.28
2	亦庄国投	2,569.59	32.98
3	圆合电子	1,221.95	8.78
4	北京工投	437.20	5.61
5	七星华电	272.94	3.50
6	中科院微电子所	250.40	3.21
7	北大宇环	45.07	0.58
8	清华研究院	45.07	0.58

9	中科院光电所	45.07	0.58
	合计	7,791.72	100

6、2014 年 1 月，第四次增资扩股

2013 年 12 月 10 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司拟增资项目资产评估报告书》（编号：天兴评报字[2013]第 941 号）。经该评估机构确认，截至 2013 年 9 月 30 日北方微电子净资产评估值为 40,129.48 万元。

2014 年 1 月 15 日，北方微电子召开 2014 年第一次临时股东会并作出决议，一致同意北京电控以北京市国有资产监督管理委员会京国资[2013]176 号文规定的 800 万元北京市国拨资金对公司增资，增资价格以北京天健兴业资产评估公司对公司截至 2013 年 9 月 30 日为基准日的每股净资产评估值 5.15 元为依据，增资后公司注册资本由 7,791.72 增至 7,947.06 万元。

2014 年 6 月 3 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于北京电子控股有限责任公司拟对北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司增资评估项目予以核准的批复》（编号：京国资产权字[2014]88 号），同意对本次北方微电子增资扩股资产评估项目予以核准。

本次增资扩股完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	3,059.77	38.50
2	亦庄国投	2,569.59	32.33
3	圆合电子	1,221.95	15.38
4	北京工投	437.20	5.50
5	七星华电	272.94	3.43
6	中科院微电子所	250.40	3.15
7	北大宇环	45.07	0.57
8	清华研究院	45.07	0.57
9	中科院光电所	45.07	0.57

	合计	7,947.06	100
--	----	----------	-----

7、2014 年 8 月，第五次增资扩股

2014 年 8 月 8 日，北方微电子召开 2014 年第三次临时股东会并作出决议，一致同意北京电控对公司增资 3,893.2 万元，增资价格为 5.15 元/每出资额，增资后公司注册资本为 11,840.26 万元。

本次增资价格系以经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准的北方微电子截至 2013 年 9 月 30 日经评估净资产为基础。

本次增资扩股完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	6,952.97	58.72
2	亦庄国投	2,569.59	21.70
3	圆合电子	1,221.95	10.32
4	北京工投	437.20	3.69
5	七星华电	272.94	2.31
6	中科院微电子所	250.40	2.11
7	北大宇环	45.07	0.38
8	清华研究院	45.07	0.38
9	中科院光电所	45.07	0.38
	合计	11,840.26	100

8、2014 年 9 月，第一次减少注册资本

2014 年 9 月 10 日，北方微电子召开 2014 年第四次临时股东会并作出决议，一致同意亦庄国投以定向减资方式退出全部出资额 2,569.59 万元，减资作价原则上以截至 2014 年 8 月 31 日评估基准日亦庄国投持有股权的评估值与其在《增资协议》规定的基础价格孰高原则确定。减资后公司注册资本为 9,270.67 万元。

2014 年 9 月 30 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《北京亦庄国际投资发展有限公司拟对北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司减资项目资产评估报告书》（编号：天兴评报字[2014]第 0923 号）。经该评估机构

确认，截至 2014 年 8 月 31 日北方微电子净资产评估值为 68,059.17 万元。

2014 年 10 月 30 日，北京经济技术开发区国有资产管理办公室出具《关于北京亦庄国际投资发展有限公司对北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司减资评估项目予以核准的批复》（编号：京开国资[2014]56 号），同意对本次北方微电子减资评估项目予以核准。

2014 年 10 月 30 日，北京经济技术开发区国有资产管理办公室出具《关于同意北京亦庄国际投资发展有限公司对北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司减资的批复》（编号：京开国资[2014]57 号），同意亦庄国投以不低于 14,995.80 万元的价格退出北方微电子。

本次减少注册资本完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	6,952.97	75.00
2	圆合电子	1,221.95	13.181
3	北京工投	437.20	4.726
4	七星华电	272.94	2.944
5	中科院微电子所	250.40	2.701
6	北大宇环	45.07	0.486
7	清华研究院	45.07	0.486
8	中科院光电所	45.07	0.486
	合计	9,270.67	100

9、2015 年 8 月，第六次增资扩股

2015 年 4 月 5 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司拟股权变动项目资产评估报告书》（编号：天兴评报字[2015]第 0170 号）。经该评估机构确认，截至 2014 年 12 月 31 日北方微电子净资产评估值为 56,383.57 万元。

2015 年 8 月 15 日，北方微电子召开 2015 年第一次临时股东会并作出决议，一致同意圆合电子对公司增资 580 万元，增资价格以北京天健兴业资产评估公

司对公司截至 2014 年 12 月 31 日为基准日的评估每股净资产为原则确定，增资后公司注册资本由 9,270.67 万元增至 9,850.67 万元。

2015 年 11 月 26 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于对北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司股权变动资产评估项目予以核准的批复》（编号：京国资产权[2015]208 号），同意对本次北方微电子股权变动资产评估项目予以核准。

本次增资扩股完成后，北方微电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京电控	6,952.97	70.58
2	圆合电子	1,801.95	18.29
3	北京工投	437.20	4.44
4	七星华电	272.94	2.77
5	中科院微电子所	250.40	2.54
6	北大宇环	45.07	0.46
7	清华研究院	45.07	0.46
8	中科院光电所	45.07	0.46
	合计	9,850.67	100

10、2015 年 11 月，第二次减少注册资本

2015 年 10 月 28 日，北方微电子召开 2015 年第二次临时股东会并作出决议，一致同意北京工投、北大宇环、清华研究院、中科院光电所以定向减资方式分别退出各自的全部出资额 437.20 万元、45.07 万元、45.07 万元、45.07 万元，减资作价原则以截至 2014 年 12 月 31 日评估基准日并经北京市国资委核准后的评估值确定。减资后公司注册资本由 9,850.67 万元减至 9,278.26 万元。

2015 年 11 月 30 日，北方微电子与北京工投、北大宇环、清华研究院、中科院光电所及其他股东签订《减资协议》，约定北京工投、北大宇环、清华研究院、中科院光电所以定向减资方式退出北方微电子，并将公司注册资本减少至 9,278.26 万元。

2015年11月28日,方微电子召开2015年第三次临时股东会并作出决议,一致同意北京工投、北大宇环、清华研究院、中科院光电所以定向减资方式分别退出各自的全部出资额437.20万元、45.07万元、45.07万元、45.07万元,减资作价以截至2014年12月31日评估基准日并经北京市国资委核准后的评估值确定,分别为27,611,030元、2,847,370元、2,847,370元、2,847,370元。减资后公司注册资本由9,850.67万元减至9,278.26万元。

本次减少注册资本完成后,北方微电子的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京电控	6,952.97	74.94
2	圆合电子	1,801.95	19.42
3	七星华电	272.94	2.94
5	中科院微电子所	250.40	2.70
	合计	9,278.26	100

12、2015年12月,第三次减少注册资本

由于圆合电子尚未履行580万元增资的缴纳义务,2015年12月15日,北方微电子召开2015年第四次临时股东会并作出决议,一致同意将注册资本由9,278.26万元减少至8,698.26万元,由圆合电子通过定向减资方式减少其认缴的北方微电子580万元出资额,其他股东不进行减资;减资完成后,圆合电子持有北方微电子1,221.95万元的出资额。

本次减少注册资本完成后,北方微电子的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京电控	6,952.97	74.94
2	圆合电子	1,221.95	14.05
3	七星华电	272.94	3.14
5	中科院微电子所	250.40	2.88
	合计	8,698.26	100

经核查北方微电子的工商登记(备案)材料,本所律师认为,北方微电子历

次增资、减资行为均经股东会决议通过且签署了相关协议并已履行完毕,符合《公司法》及其他法规的相关规定;北方微电子股东所持有的股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形,也不存在纠纷或潜在纠纷;北方微电子不存在影响其合法存续的情况。

综上所述,本所律师认为,

(1) 北方微电子系一家依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规、规范性文件或其公司章程需要终止的情形;

(2) 北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所依法合计持有北方微电子100%的股权,该等股权权属清晰,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在质押或其他重大权利限制的情形;

(3) 北京电控、圆合电子、七星华电、中科院微电子所以其合计持有的北方微电子100%股权认购七星电子非公开发行的股份不存在法律障碍。

(三) 对外投资

根据北方微电子提供的工商资料和北方微电子的说明,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,北方微电子无子公司。

(四) 主营业务及业务资质

根据北方微电子《公司章程》及《营业执照》的记载,北方微电子经北京市工商局核准的经营范围为生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售电子产品、机械设备(小汽车除外)、五金交电;自有厂房出租;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

为从事现有主营业务,北方微电子已取得如下业务资质或许可:

(1) 海关报关单位注册登记证书

2015年5月25日,北方微电子取得中华人民共和国北京海关核发的《海关报关单位注册登记证书》(海关注册编码:1113210076),有效期为长期。

（2）自理报检单位备案登记证书

2012年8月1日，北方微电子取得中华人民共和国北京出入境检验检疫局核发的《自理报检单位备案登记证书》（备案登记号：1100605553）。

（3）对外贸易经营者备案登记表

2012年5月4日，北方微电子取得了《对外贸易经营者备案登记表》（编号：01016767）。

据此，本所律师认为，北方微电子已经取得从事生产经营活动所需的业务许可。

（五）相关资质认证

序号	证书名称	证书编号	授予时间	认证机构	有效期至
1	ISO9001	CNBJ320663-UK	2014.11	必维认证（北京）有限公司	2017.11
2	ISO14001	CNBJ320664-UK	2014.11	必维认证（北京）有限公司	2017.11
3	OHSAS18001	CN100029A	2014.11	必维认证（北京）有限公司	2017.11
4	CMMI3 级	CMMIDEV/3 APPRAISAL*23587	2014.12	美国 SEI	2017.12
5	SEMI 认证- Booster A630	SEMI10208	2015.08	Electronic Technical Test Crop.(ECMG)	长期有效
6	SEMI 认证 -exiTin	SEMI10089	2012.11	Electronic Technical Test Crop.(ECMG)	长期有效
7	SEMI 认证 -NMC612A	WA 50193522 01	2010.12	TUV Rheinland of North America,Inc	长期有效
8	SEMI 认证 -NMC612C	WA 50273382 01	2014.01	TUV Rheinland of North America,Inc	长期有效
9	SEMI 认证 -eVictor A830	SEMI10204	2015.08	Electronic Technical Test Crop.(ECMG)	长期有效
10	CE-NMC508A	AN 50111109 0001	2007.09	TUV Rheinland of North America,Inc	长期有效
11	CE-DYG-E-200	AN 50106384 0001	2007.05	TUV Rheinland of North America,Inc	长期有效
12	国家高新科技	GF201311000358	2013.11	北京市科学技术委员会	2016.11

	企业证书			国家税务总局 北京市财政局 北京市地方税务局	
13	中关村高新技术企业证书	20152050013004	2015.09	中关村科技园区管理委员会	2018.09
14	北京市工程技术研究中心证书	BG0261	2015.05	北京市科学技术委员会	2018.05
15	AEO 认证企业证书	801786752001	2014.12	中华人民共和国北京海关	长期有效

（六）主要资产

根据《评估报告》、北方微电子提供的资料及说明，北方微电子拥有或使用的主要资产包括土地、房屋、商标、车辆和办公设备，具体情况如下：

1、土地使用权

截至本法律意见书出具之日，北方微电子拥有的土地使用权共计 1 宗，具体如下：

权证编号	坐落	类型	用途	使用权面积 (平方米)	终止日期	他项权
开有限国用(2006)第 53 号	北京经济技术开发区 54 号街区	出让	工业	103,603.70	2056.12.29	已抵押

根据发行人提供的上述土地《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》、《土地使用权出让合同》、土地出让金支付凭证及《国有土地使用证》，本所律师核查后认为，发行人拥有的国有土地使用权真实、合法、有效，不存在产权纠纷或潜在纠纷，未被司法查封或冻结。

2、房屋所有权

（1）截至本法律意见书出具之日，北方微电子拥有的房屋所有权共计 1 项，具体如下：

房屋所有权证号	房屋座落	用途	建筑面积(平方米)	他项权
---------	------	----	-----------	-----

X 京房权证开字第 013001 号	北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢等 2 幢	微电子装备楼	39,412.02	已抵押
		厂房	5,399.99	

2015 年 5 月，北方微电子对微电子装备楼进行内部改造，建筑面积由 39,412.02 平方米变更为 40,962.85 平方米。2015 年 5 月 11 日，北京市住房和城乡建设委员会出具《行政审批事项办理结果通知单》，对北方微电子申请的房屋测绘成果（权属登记）审核通过。截至本法律意见书出具之日，房屋所有权证书登记建筑面积尚未变更。

根据发行人提供的上述房屋权属证书，本所律师核查后认为，发行人拥有的上述房屋所有权真实、合法、有效，不存在产权纠纷或潜在纠纷，未被司法查封或冻结。

（2）除上述已取得产权证书的房产外，发行人尚有 4 项房屋未取得产权证书，具体如下：

房屋用途	建筑面积（平方米）
9a 号门卫室	24
9b 号门卫室	15
9c 号门卫室	10
6 号化学品库	276

经核查，北方微电子兴建上述房屋前已于 2010 年 9 月 14 日取得北京市规划委员会核发的《建筑工程规划许可证》（编号：2010 规[开]建字 0104 号）。北方微电子正在办理上述房屋竣工验收及房屋所有权权属登记手续。

本所律师认为，根据《建设工程施工许可管理办法》的规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。北方微电子建造上述房屋已履行规划手续，合法施工。

北方微电子控股股东北京电控已作出承诺敦促北方微电子于本次重组完成前办理完毕该等房产的权属登记手续；如本次交易完成后北方微电子该等房产仍未办理完成权属登记手续，将由北京电控承担该等房产后续办理房屋权属登记的

相关费用；本次重组完成后，如上述房产因未办理权属登记而被政府部门限制使用、行政处罚或被责令拆除，或发生任何其他对北方微电子生产经营造成损失的情况，北京电控将对上市公司进行足额赔偿。

据此，上述房屋未取得房屋产权证书对本次重组不构成法律障碍。

3、知识产权

(1) 商标权

截至本法律意见书出具之日，北方微电子拥有**11**项注册商标，其中国内注册商标**10**项、国外注册商标**1**项。具体如下：

序号	商标名称	注册号/申请号	国际分类	注册地	有效期
1		9040742	第7类	中国	2012.01.21-2022.01.20
2		13036631	第7类	中国	2014.12.28-2024.12.27
3		13011504	第7类	中国	2014.12.14-2024.12.13
4		7246016	第7类	中国	2010.08.07-2020.08.06
5	爱信德	7246015	第7类	中国	2010.08.07-2020.08.06
6		7589859	第9类	中国	2011.03.14-2021.03.13
7		7246014	第7类	中国	2011.07.14-2021.07.13
8	羲寻	7246013	第7类	中国	2010.08.07-2020.08.06
9		4800007	第7类	中国	2008.06.07-2018.07.07
10		13011506A	第7类	中国	2015.05.21-2025.05.20

11		01686708	第7类	中国 台湾	2015.01.16-2025.01.15
----	---	----------	-----	----------	-----------------------

经核查上述商标的注册证书并通过检索互联网，本所律师认为，北方微电子拥有的上述注册商标真实、合法、有效，北方微电子对其权利的行使不存在法律限制，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(2) 专利权

截至本法律意见书出具之日，北方微电子拥有**566**项国内发明专利，**45**项国内实用新型专利，**55**项国际专利。北方微电子拥有的专利权详见本法律意见书之附件“北方微电子专利权情况”。

其中，刻蚀机集群控制器与工艺模块控制器通讯系统及方法（专利号：**ZL200610011316.6**）、刻蚀机集群控制器（专利号：**ZL200610011922.8**）、实现射频阻抗匹配的方法及射频阻抗匹配系统（专利号：**ZL200710120494.7**）三项发明专利为北方微电子和清华大学共有。为此，北方微电子与清华大学共同签订《刻蚀机标准化驱动系统研发技术开发合同书》，约定双方共同享有技术成果的专利申请权、使用权、署名权、荣誉权和申请奖励权。根据该合同，清华大学享有利用该核心技术开发其他项目或系统的权利。清华大学承诺，在北方微电子完全履行合同总额支付的情况下，未经北方微电子书面许可，清华大学不得提供给集成电路装备同领域与北方微电子形成竞争关系的第三方使用。截至本法律意见书出具之日，双方未因共有专利问题产生任何纠纷，上述专利共有未对北方微电子正常生产经营产生任何负面影响。

经核查上述专利的权属证书、专利授予通知并通过检索互联网，本所律师认为，北方微电子拥有的上述专利权真实、合法、有效，北方微电子对其权利的行使不存在法律限制，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(3) 著作权

截至本法律意见书出具之日，北方微电子拥有 **43** 项软件著作权。具体如下：

序号	著作权名称	版本	登记号	取得方式	权利范围	首次 发表日期
----	-------	----	-----	------	------	------------

1	干法刻蚀设备中央控制软件	V1.0	2005SR14556	原始取得	全部权利	2004.12.15
2	干法刻蚀设备工艺模块控制软件（Etch-PMC2100）	V1.0	2005SR14559	原始取得	全部权利	2004.06.30
3	干法刻蚀设备工艺模块控制软件（Etch-PMC2101）	V1.0	2005SR14560	原始取得	全部权利	2004.09.20
4	干法刻蚀设备先进工艺控制软件	V1.0	2005SR14558	原始取得	全部权利	2005.10.25
5	干法刻蚀设备工艺模块控制软件（Etch-PMC2102）	V1.0	2005SR14557	原始取得	全部权利	2005.07.10
6	半导体设备 WEB 服务通讯软件	V1.0	2005SR14555	原始取得	全部权利	2005.09.20
7	LD Match-DCS 控制软件	V1.0	2007SR16070	原始取得	全部权利	2007.07.15
8	LD Match 上位机调试软件	V1.0	2007SR16071	原始取得	全部权利	2007.07.15
9	CLAS-Control Scheduling	V1.0	2010SR010072	原始取得	全部权利	2009.11.23
10	Industrial Automation Package	V3.0	2010SR011765	原始取得	全部权利	2009.09.29
11	ETCH 上位机 CTC 控制软件	V1.0	2013SR010451	原始取得	全部权利	2010.05.20
12	ELEDE330 软件权限模块系统	V1.0	2012SR071930	原始取得	全部权利	2010.08.18
13	ELEDE330 软件数据模块系统	V1.0	2012SR097393	原始取得	全部权利	2010.08.18
14	LEMO 下位机控制软件	V1.0	2013SR004772	原始取得	全部权利	2012.11.26
15	iTOPS 上位机控制软件	V1.0	2012SR101810	原始取得	全部权利	2012.06.19
16	iTOPS 下位机控制软件	V1.0	2012SR101817	原始取得	全部权利	2012.06.19
17	LEMO 上位机控制软件	V1.0	2013SR004624	原始取得	全部权利	2012.06.19
18	IAP 控制系统软件	V1.0	2013SR010496	原始取得	全部权利	2012.06.30
19	CTC 平台软件	V1.0	2013SR009981	原始取得	全部权利	2012.09.10
20	GSE 上位机控制软件	V1.0	2013SR018369	原始取得	全部权利	2012.09.26

21	ACT200 膜厚仪下位机系统	V1.0	2014SR013693	原始取得	全部权利	2013.11.15
22	GDE 软件	V1.0	2015SR036956	原始取得	全部权利	2013.11.25
23	IC_ETCH_DC 数据采集控制软件	V1.0	2015SR047289	原始取得	全部权利	2013.11.27
24	APE 上位机控制软件	V1.0	2014SR058154	原始取得	全部权利	2013.12.26
25	DSE200PM 报警信息管理模块系统	V1.0	2014SR004513	原始取得	全部权利	2013.02.15
26	DSE200 下位机工艺模块系统	V1.0	2014SR004648	原始取得	全部权利	2013.02.15
27	APE300L_DC 数据采集控制软件	V1.0	2015SR047308	原始取得	全部权利	2014.02.20
28	LED-PECVD 上位机控制软件	V1.0	2014SR058170	原始取得	全部权利	2014.02.26
29	APE301L_CTCI 控制软件	V1.0	2015SR036957	原始取得	全部权利	2014.03.20
30	SES 630A 上位机控制软件	V1.0	2014SR113142	原始取得	全部权利	2014.04.01
31	SES 630A 下位机控制软件	V1.0	2014SR113440	原始取得	全部权利	2014.04.01
32	APE300L_PMC1 控制软件	V1.0	2015SR047313	原始取得	全部权利	2014.04.11
33	APE300L_TMCI 控制软件	V1.0	2015SR047317	原始取得	全部权利	2014.04.17
34	IC_ETCH_TMCI 控制软件	V1.0	2015SR047284	原始取得	全部权利	2014.04.22
35	IC_ETCH_PMC1 控制软件	V1.0	2015SR047292	原始取得	全部权利	2014.05.20
36	IC_ETCH_CTCI 控制软件	V1.0	2015SR041897	原始取得	全部权利	2014.05.29
37	PecvdCluster 上位机控制软件	V1.0	2014SR161947	原始取得	全部权利	2014.06.23
38	LES380 上位机控制软件	V1.0	2014SR161943	原始取得	全部权利	2014.07.23
39	故障诊断与分类系统	V1.0	2009SR015517	原始取得	全部权利	未发表
40	统计过程控制系统	V1.0	2009SR015518	原始取得	全部权利	未发表

41	数据采集系统	V1.0	2009SR015519	原始取得	全部权利	未发表
42	NMC508C 上位机软件 10100-3500	--	2015SR136852	原始取得	全部权利	2015.05.20
43	DSE200L 上位机软件	V1.0	2015SR105837	原始取得	全部权利	2014.10.18

经核查上述著作权的权属证书并通过检索互联网，本所律师认为，北方微电子拥有的上述计算机软件著作权真实、合法、有效，北方微电子对其权利的行使不存在法律限制，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

4、主要生产经营设备

根据北方微电子《审计报告》及主要生产经营设备清单，经本所律师核查，北方微电子生产经营设备主要如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	账面余额（万元）
1	颗粒检测仪	2	1,791.51
2	产品出厂测试平台	2	960.67
3	设备工艺模块综合测试平台	1	722.90
4	膜厚测量仪	3	573.28
5	设备控制软件系统测试平台	1	650.36
6	光刻机	3	384.89
7	场发射扫描电镜	2	218.87
8	硅片在线显微测试仪	1	11.22
9	超纯水系统	1	175.21
10	刻蚀机颗粒控制技术研究平台	1	271.79
11	LEDWafer自动检验设备	1	231.54
12	废水处理系统设备	1	144.94
合计		19	6,137.17

本所律师抽查部分机器设备的购置合同、发票等资料，该等设备处于有效使用期内，属正常使用。

（七）重大债权债务情况

1、借款及担保情况

根据北方微电子出具的资料，截至本法律意见书出具之日，北方微电子有 1 项借款合同及担保合同，具体如下：

2015 年 9 月 22 日，北方微电子与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）签订《综合授信合同》（编号：公授信字第 1500000150801 号）。合同约定，民生银行向北方微电子提供 1.5 亿元授信额度，授信期限自 2015 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日，北方微电子以名下土地使用权及地上房产作为抵押。2015 年 11 月 12 日，北方微电子与民生银行签订《流动资金贷款借款合同》（编号：公借贷字第 1500000179460 号）。合同约定，民生银行向北方微电子提供 6,000 万元借款，借款用途为“14nm 立体栅刻蚀机研发及产业化项目的前期采购和其他费用支出”，年利率为 4.611%，借款期限为 2015 年 11 月 12 日至 2016 年 11 月 12 日。

2015 年 9 月 22 日，北方微电子与民生银行签订《最高额抵押合同》（编号：公高抵字第 1500000150801 号）。合同约定，北方微电子用名下土地使用权及地上房产为其与该银行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第 1500000150801 号）提供抵押担保。

经核查，本所律师认为，北方微电子的前述借款合同、担保合同真实、合法、有效，不存在潜在风险，合同履行不存在法律障碍。

根据发行人提供的说明并经核查，北方微电子与供应商、客户及其他业务相关方不存在各种形式的融资（包括但不限于应收账款保理、内保外贷、票据贴现融资等）、担保等行为。

2、重大业务合同

（1）重大采购合同

根据北方微电子出具的资料，截至本法律意见书出具之日，北方微电子正在履行的重大采购合同如下：

序号	合同相对方	合同名称	主要内容	合同金额	签订日期	合同期限
1	北京市电力公司	高压供电合同	供电服务	按工业用电 计量计费	2012.12.12	5 年
2	北京天环燃气有限公司燃气设施维护分公司	北京市非居民天然气供用合同	工业供气服务	每立方米 6.7 元	2015.03.15	2015.03.15- 2015.12.31
3	华润协鑫(北京)热电有限公司	供用低温冷水合同	每日 24 小时不间断供应 7℃±1℃冷水服务	试运行期间 40 元/吉焦, 正式运行后 45.8 元/吉焦,天然气没 标准立方米 涨 0.1 元,水 价上涨不超过 3 元/吉焦	2010.7.21	27 年
4	华润协鑫(北京)热电有限公司	供用高温热水合同	每日 24 小时不间断供应 130℃±10℃热水服务	试运行期间 50 元/吉焦, 正式运行后 59.5 元/吉焦,天然气没 标准立方米 涨 0.1 元,水 价上涨不超过 3 元/吉焦	2010.7.21	27 年
5	北京科住物业管理有限公司	物业管理服务合同	提供厂房及园区物业服务	176.644 万 元	2015.01.01	2015.01.01- 2015.12.31

(2) 重大销售合同

根据北方微电子出具的资料,截至本法律意见书出具之日,北方微电子正在履行的重大销售合同如下:

序号	合同相对方	合同名称	主要内容	合同金额 (万元)	签订日期
1	昆山西钛微电子科技有限公司	设备购销合同	G620、T420 型号溅射机各 1 台	2,050	2013.07.19
2	华进半导体封装先导技术研发中	技术设备采购合同	TSV 物理气相沉积系统 1 套	1,995	2013.10.10

	心有限公司				
3	昆山西钛微电子科技有限公司	设备购销合同	DSE200C 蚀刻机 6 台、 GDE200C 蚀刻机 1 台、 高精度膜厚检测及自动 导片一体机 1 台	2,250	2013.07.19
4	江苏昆山高新技术产业投资发展有限公司	合同书	330SGE+ 型号感应耦合 等离子刻蚀机 2 台、 330S+型号感应耦合等离 子刻蚀机 1 台	950	2013.12.17
5	苏州晶方半导体科技股份有限公司	设备买卖合同	12 寸全自动 PVD 设备 1 套	1,621	2012.06.18
6	东莞市中镓半导体科技有限公司	产品购销合同	LED ICP 刻蚀机 3 台	930	2013.08.26
7	苏州科阳光电科技有限公司	设备采购合同	气相蚀刻机 4 台	3,050	2013.10.09
8	上海华力微电子有限公司	多晶硅刻蚀机设备 及备品备件采购合 同	多晶硅刻蚀机、多晶硅 刻蚀机主机台相关备品 备件	3,323.6121	2014.12.04
9	上海华力微电子有限公司	金属硬掩膜氮化钛 膜沉积设备采购合 同	金属硬掩膜氮化钛膜沉 积设备 1 套	2,956.9614	2014.12.04
10	华灿光电股份有限公司	合同	A1N 磁控溅射设备	4,250	2015.03.27
11	东莞市中图半导体科技有限公司	产品购销合同	LED ICP 刻蚀机 4 台	1,192	2014.03.11
12	华灿光电股份有限公司	合同	A1N 磁控溅射设备 1 台	720	2014.12.30
13	华天科技（昆山）电子有限公司	设备购销合同	T630 溅射机 1 台	1,750	2014.12.04
14	华灿光电股份有限公司	合同	LED ICP 刻蚀机 3 台	982.8	2013.06.06
15	一宝科技股份有限公司	合同	ICP 刻蚀机 2 台	82 万美元	2013.01.30
16	晶宇光电（厦门）有限公司	采购单	ICP 刻蚀机 1 台、 iTOPSi2301 台、 iTOPSi230-sputter1 台	1,250	2014.10.09

17	晶能光电（江西）有限公司	采购合同	ICP 刻蚀机 2 台	590	2014.05.16
18	西安微电子技术研究所	合同	薄膜成膜系统 1 套	1,138.94	2014.11.24
19	上海华虹宏力半导体制造有限公司	采购订单	NMC508C1 台	936	2015.06.04
20	苏州新纳晶光电有限公司	合同	LED 等离子刻蚀机 2 台	576	2014.09.09

经核查，本所律师认为，上述采购、销售合同均真实、合法、有效，不存在潜在风险，合同的履行不存在法律障碍。

（八）税务情况

1、税务登记

北方微电子现持有北京市国家税务局、北京市地方税务局于2011年11月14日联合核发的《税务登记证》（编号：税开国字110192801786752号）。

2、主要税种、税率

根据瑞华所出具的《北方微电子审计报告》，北方微电子的主要税种、税率如下：

税种	纳税（费）基础	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口设备等货物	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
所得税	应纳税所得额	15%

3、税收优惠及财政补贴

（1）税收优惠

根据《审计报告》并经本所律师核查，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火

[2008]362号) 有关规定, 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发《高新技术企业证书》, 认定北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司为高新技术企业, 2010年至2013年, 2014年至2016年, 北方微电子企业所得税税率减按15%执行。

(2) 政府补助

根据《审计报告》经本所律师核查, 北方微电子报告期内收到的政府补助详细情况如下:

单位: 元

补助项目	2015 年 1-11 月	2014 年	2013 年	与资产相关/与收益相关
45/22nm PVD 设备研发与产业化项目	132,834,340.39	127,851,165.95	0	与资产相关、与收益相关
90/65nm 高密度等离子刻蚀机研发与产业化项目	47,264,577.45	30,464,353.86	82,130,107.12	与资产相关、与收益相关
14nm 立体栅刻蚀机研究及产业化项目	88,443,026.31	63,960,999.99		与资产相关、与收益相关
65-45nm PVD 设备研发项目	6,424,532.26	4,105,841.30	4,287,556.26	与资产相关、与收益相关
32/22nm 栅刻蚀机研发及产业化项目	3,242,841.12	75,363,917.29	131,097,855.73	与资产相关、与收益相关
半导体外延关键技术研发项目	517,262.78	440,209.53	196,085.08	与资产相关、与收益相关
半导体衬底工艺开发项目	108,714.95	123,492.78	53,012.07	与资产相关、与收益相关
关键溅射技术研究项目	330,412.60	707,042.62		与资产相关、与收益相关
溅射设备样机研制项目	2,400,000.00			与收益相关
中关村技术创新能力建设(专利部分)资助金	518,500.00	200,000.00		与收益相关
国家知识产权局北京代办处专利资助金	564,600.00	829,250.00	539,320.00	与收益相关

单位：元

补助项目	2015 年 1-11 月	2014 年	2013 年	与资产相关/与收益相关
中国共产党北京市委员会组织部优秀人才资助款	50,000.00	25,000.00		与收益相关
北京经济技术开发区财政局海外学人中心-博士后科研经费资助	50,000.00	500,000.00	500,000.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会补贴	41,000.00	1,000.00	470,000.00	与收益相关
北京市人力资源与社会保障局博士后工作站补助	40,000.00	50,000.00		与收益相关
北京商务委进口贴息款	2,800,000.00	4,297,337.00	2,210,271.00	与收益相关
北京外国专家与外国人就业事务中心补助	300,000.00			与收益相关
工业和信息化部两化融合款		100,000.00		与收益相关
开发区财政局知识产权拨款		2,086,000.00		与收益相关
北京大学国家自然科学基金拨款	300,000.00			与收益相关
有机金属氧化物沉积设备研制			8,044,231.21	与收益相关
开发区财政拨付科技创新项目资金			2,541,560.00	与收益相关
北京人保新世纪百千万人才工程培养经费资助款			50,000.00	与收益相关
环保局 2013 年环境发展资金补贴			2,880.00	与收益相关
科委 2013 年北京市高新技术成果转化专项资金			1,000,000.00	与收益相关
其他	6,603.77			与收益相关
合计	286,236,411.63	311,105,610.32	233,122,878.47	

4、纳税情况

根据《审计报告》、北方微电子所作说明并经核查，报告期内北方微电子未

受到税务违法违规处罚记录。

本所律师认为，北方微电子目前不存在违反相关税务法律、法规的规定而导致对其产生或可能产生重大不利影响之情形。

（九）仲裁、诉讼及行政处罚

经本所律师核查并经北方微电子的书面确认，北方微电子有一宗仲裁案正在审理中，情况如下：

2013年1月，北方微电子与一宝科技股份有限公司签署合同，北方微电子向其销售ICP刻蚀机2台，合同金额为82万美元。北方微电子已向对方发货1台，对方仅支付10%预付款，剩余货款至今未支付。经双方多次沟通协商未达成一致。2015年7月20日，北方微电子向上海仲裁委员会申请仲裁，要求对方支付剩余设备款36.9万美元及违约金21.6万美元。上海仲裁委员会受理并出具《受理通知书》（编号：[2015]沪仲裁字第1112号）。截至本法律意见书出具之日，该仲裁案件仍在审理中。

除上述未决仲裁外，北方微电子不存在可能影响本次重组的重大诉讼、仲裁、行政处罚或其他潜在法律风险。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，北方微电子不存在对本次重组构成实质影响的重大法律事项和潜在法律风险；北方微电子不存在尚未结案的、已经结案但尚未执行完毕的或者可预见的行政处罚案件。

六、本次重组涉及的债权债务处理

根据本次重组方案，本次重组不涉及标的公司债权债务的转移或处置，标的公司原有的债权债务仍由本次重组后的标的公司享有或承担。据此，本所律师认为，本次重组不存在侵害相关方利益的情形。

七、关联交易和同业竞争

（一）关联交易

1、本次重组构成关联交易

本次重组的交易对方北京电控、七星华电、圆合电子属于七星电子的关联方，本次重组构成七星电子的关联交易。

2、本次重组后的关联交易

（1）本次重组完成后新增关联方情况

本次重组完成后，发行对象集成电路产业基金因持有七星电子 3,430.53 万股股份，持股比例超过 5%，为七星电子新的关联方。

（2）本次重组前后关联交易情况

根据《北方微电子审计报告》，2013 年至 2015 年 11 月，七星电子及其子公司与北方微电子的关联交易情况如下：

金额：元

关联方	交易内容	2015 年 1-11 月	2014 年	2013 年
发行人	采购商品	1,829,729.46	2,101,282.05	1,625,349.74
发行人	接受劳务	149,700.00	107,830.19	0
北京七星飞行电子有限公司	采购商品	41,800.00	31,196.57	12,051.00
北京七一八友晟电子有限公司	采购商品	19,198.00	78,562.41	79,623.00
北京七一八友益电子有限责任公司	采购商品	0	3,996.57	256.00
北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司	接受劳务	0	0	17,094.00
北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司	销售商品	0	0	19,500.00
北京晨晶电子有限公司	销售商品	10,000,000.00	0	0

本次重组完成后，七星电子与北京电控、七星华电及其关联企业之间关联交易将继续严格按照有关规范关联交易的法律法规及《公司章程》的要求履行关联交易的决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

3、交易对方关于减少及规范关联交易的承诺

(1) 为规范未来可能发生的关联交易行为，交易对方七星华电已出具了如下承诺：

①本次重组完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利。本次重组完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。如未来上市公司预计与本公司及本公司控制的其他企业之间持续发生交易的，本公司将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。

②本公司将继续履行已向上市公司作出的相关减少并规范关联交易的承诺。

③如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

④本承诺函自作出之日起至本公司不再为上市公司控股股东时终止。

(2) 为规范未来可能发生的关联交易行为，交易对方北京电控已出具了如下承诺：

①本次重组完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利。本次重组完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。如未来上市公司预计与本公司及本公司控制的其他企业之间持续发生交易的，本公司将采取

有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。

②本公司将继续履行已向上市公司作出的相关减少并规范关联交易的承诺。

③如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

④本承诺函自作出之日起至本公司不再为上市公司实际控制人时终止。

本所律师认为，上述承诺合法有效，有利于保护上市公司及其非关联股东的合法权益。

（二）同业竞争

本次重组并未导致七星电子的控股股东、实际控制人发生变更。七星电子控股股东、实际控制人及其控制的企业，目前未从事任何与七星电子及北方微电子主营业务构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。本次重组完成后，七星电子控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争的情况。

（1）为避免本次重组完成后与上市公司之间存在同业竞争，交易对方七星华电已出具了如下承诺：

①本次重组完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将继续不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。

②本公司将继续履行已向上市公司作出的相关避免同业竞争的承诺。

③如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或在不影响上市公司利益的前提下将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格在适当时机全部转让给上市公司。

④如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

⑤本承诺函自作出之日起至本公司不再为上市公司控股股东时终止。

(2) 为避免本次重组完成后与上市公司之间存在同业竞争，北京电控已出具了如下承诺：

①本次重组完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将继续不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。

②本公司将继续履行已向上市公司作出的相关避免同业竞争的承诺。

③如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或在不影响上市公司利益的前提下将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格在适当时机全部转让给上市公司。

④如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

⑤本承诺函自作出之日起至本公司不再为上市公司实际控制人时终止。

本所律师认为，本次重组不会致使上市公司与实际控制人及其关联企业之间产生同业竞争；七星华电、北京电控已就本次重组完成后与发行人之间避免同业竞争的措施作出了有效承诺，该等承诺真实、有效，有利于避免同业竞争。

八、本次重组的实质条件

(一) 本次重组符合《重组办法》第十一条之规定

1、根据《重组报告书》、有关工商、税务等主管部门出具的证明文件，七

星电子和交易对方提供有关资料和说明，标的公司的生产经营符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

据此，本次重组符合《重组办法》第十一条第（一）项之规定。

2、根据《重组报告书》，本次发行股份购买资产交易拟发行股份 5,281.14 万股，本次募集配套资金拟发行股份 5,281.14 万股。在本次重组完成之后，七星电子的总股本增至 45,782.29 万股，其中社会公众股股份数量占本次重组完成后七星电子股份总数的比例不低于 10%。据此，本次重组不会导致七星电子不符合股票上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项之规定。

3、根据《重组报告书》并经核查，标的资产的价值已经具有证券从业资格的评估机构亚超评估。七星电子董事会会议就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了审议并形成了明确意见。七星电子董事会在审议本次重组的相关议案时，关联董事均已回避表决相关议案，独立董事已对本次关联交易发表了独立董事意见，本次重组涉及的关联交易决策程序遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司章程》的相关规定。据此，本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害七星电子及其股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项之规定。

4、根据北方微电子工商登记（备案）资料、交易对方承诺、《重组报告书》并经核查，本次重组所涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得以适当履行的情况下，资产过户或者移转不存在实质性法律障碍，能在约定期限内办理完毕权属转移手续，本次重组不改变相关各方各自自身债权债务的享有和承担方式，符合《重组办法》第十一条第（四）项之规定。

5、根据《重组报告书》并经核查，本次重组有利于七星电子增强持续经营能力，不存在可能导致七星电子重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组办法》第十一条第（五）项之规定。

6、根据《重组报告书》并经核查，本次重组完成之后，七星电子的控股股东及实际控制人未发生变更，七星电子与控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续保持其独立性，符合中国证监会

关于上市独立性的相关规定，符合《重组办法》第十一条第（六）项之规定。

7、根据《重组报告书》并经核查，七星电子已经依照《公司法》及公司章程的规定建立了股东大会、董事会和监事会等治理结构，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并根据业务运作的需要设置了内部职能部门，具有健全的组织机构；并已制定了健全的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等工作制度。本次重组完成后七星电子能够继续保持健全有效的法人治理结构，符合《重组办法》第十一条第（七）项之规定。

（二）本次重组符合《重组办法》第四十三条之规定

1、根据《重组报告书》、《备考审计报告》以及七星电子和交易对方出具有关承诺并经核查，本次重组有利于提高上市公司资产质量和增强持续盈利能力。七星华电、北京电控、圆合电子均出具了减少及规范关联交易的承诺，该等承诺合法有效，有利于保护上市公司及其非关联股东的合法权益。为避免与上市公司之间存在同业竞争，七星华电、北京电控已出具避免同业竞争的承诺。据此，符合《重组办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

2、根据瑞华所出具的《备考审计报告》并经核查，七星电子最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《重组办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

3、根据七星电子提供的 2014 年度报告及承诺，七星电子现任董事、高级管理人员出具的承诺并经核查，七星电子及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

4、本次重组标的资产为北方微电子 100%的股权，北方微电子是依法设立并合法存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规、规范性文件或其公司章程需要终止的情形；交易对方依法合计持有标的公司 100%的股权，该等股权权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在质押或其他重大权利限制的情形，能在约定期限内办理完毕权属转移手续，符合《重组办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

5、根据《重组报告书》并经核查，本次重组完成后，七星电子控制权不发生变更。上市公司本次收购北方微电子，北方微电子的优质集成电路设备业务及相关资产将进入上市公司，上市公司的收入规模和盈利能力将得以显著提升，有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，符合《重组办法》第四十三条第二款之规定。

（三）本次重组符合《重组办法》第四十四条之规定及适用意见规定

《重组办法》第四十四条及其适用意见规定：上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过 100%的，一并由发行审核委员会予以审核。

本次重组上市公司将募集配套资金 92,367.22 万元，定价方式按照《发行管理办法》的规定执行；募集配套资金用于北方微电子“微电子装备扩产项目”建设及补充上市公司流动资金，募集配套资金总额不超过本次重组总金额的 100%。七星电子已编制了对应的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，并拟向中国证监会提出申请，符合《重组办法》第四十四条的规定。

（四）本次重组符合《重组办法》的其他规定

1、根据七星电子董事会会议决议，本次发行股份的定价基准日为董事会会议通过本次重组相关议案之决议公告之日，即 2015 年 12 月 25 日；本次发行股份购买资产的发行价格为 17.49 元/股（即公司审议本次重组相关事宜的董事会决议公告日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价的 90%）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行价格相应调整。据此，七星电子发行股份的价格不低于本次发行股份购买资产的董事会会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，符合《重组办法》第四十五条之规定。

2、根据相关董事会决议、《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》，北京电控、七星华电、集成电路产业基金、芯动能基金、京国瑞基金就其本次重组所取得的七星电子股份锁定期出具了承诺，承诺各自取得的本次重组所发行的

股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让，符合《重组办法》第四十六条之规定。

综上所述，本所律师认为，七星电子本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的原则和实质性条件。

九、本次重组的信息披露

经核查，截至本法律意见书出具之日，七星电子在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的本次重组公告及信息披露情况如下：

2015 年 10 月 9 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》；2015 年 10 月 15 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》；2015 年 10 月 22 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》；2015 年 10 月 30 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告》；2015 年 11 月 6 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》；2015 年 11 月 13 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》；2015 年 11 月 20 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》；2015 年 11 月 27 日、2015 年 12 月 4 日、2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 18 日、2015 年 12 月 25 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》；2015 年 12 月 26 日，七星电子发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于交易的一般风险提示暨暂不复牌公告》；2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 8 日，七星电子发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》；2016 年 1 月 11 日，七星电子发布了《发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案(修订稿)》、《关于公司股票复牌的提示性公告》。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，七星电子已履行了应履行的法定信息披露义务。根据七星电子及交易对方的确认，本次重组的相关各方不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

十、关于本次重组相关人员买卖证券行为的核查情况

根据七星电子、交易对方和相关中介机构提交的内幕信息知情人名单、相关公司和人员出具的自查报告和买卖股票的情况说明、中登公司出具的查询证明，并经本所律师核查，七星电子及其董事、监事、高管人员、交易对方及标的公司董事、监事、高管人员、相关证券服务机构及其他知悉本次重组的法人和自然人、以及上述相关人员的直系亲属（以下简称“自查范围内人员”）在七星电子因本次重组股票停牌日（2015年10月8日）前六个月至《重组报告书》披露日（以下简称“自查期间”）期间买卖七星电子股票的情况如下：

1、七星电子及其董事、监事、高管人员买卖七星电子股票情况：

公司董事会秘书徐加力买卖公司股票情况如下：

姓名	证券简称	累计买入（股）	累计卖出（股）	截至目前结余股数（股）
徐加力	七星电子	254,898	0	254,898

根据中国证监会2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），七星电子于2015年7月10日发布《关于维护公司股价稳定的公告》，并承诺“在法律、法规允许范围内，公司董事、监事和高级管理人员将根据自身资金状况，自2015年7月13日起未来六个月内，择机增持公司股票，合计增持金额不低于人民币500万元”。根据七星电子及徐加力所作说明，徐加力作为七星电子高级管理人员，在自查期间买入“七星电子”挂牌A股股票的行为系完成上述承诺的要求，与本次重组无关联。

2、交易对方及其董事、监事、高管人员买卖七星电子股票情况：

（1）北京电控法务部副部长焦健买卖公司股票情况如下：

姓名	证券简称	累计买入（股）	累计卖出（股）	截至目前结余股数（股）
焦健	七星电子	1,200	1,200	0

根据焦健所作说明并经核查，焦健没有参与本次重大资产重组的决策过程，

亦不知悉任何未公开披露的有关七星电子本次重大资产重组的内容和信息，不属于相关法律法规及规范性文件规定的内幕信息的知情人员。焦健的上述买卖“七星电子”挂牌交易 A 股股票行为系在并未获知任何本次七星电子重大资产重组有关信息的情况下，基于对二级市场交易情况和个人独立判断而进行的投资决策，与本次重组无关联。

(2) 七星华电监事邵华标之女邵一鸣买卖公司股票情况如下：

姓名	证券简称	累计买入（股）	累计卖出（股）	截至目前结余股数（股）
邵一鸣	七星电子	6,500	6,500	0

根据邵华标所作说明并经核查，邵华标没有参与本次重大资产重组的决策过程，亦不知悉任何未公开披露的有关七星电子本次重大资产重组的内容和信息，不属于相关法律法规及规范性文件规定的内幕信息的知情人员。邵一鸣的上述买卖“七星电子”挂牌交易 A 股股票行为系在并未获知任何本次七星电子重大资产重组有关信息的情况下，基于对二级市场交易情况和个人独立判断而进行的投资决策，与本次重组无关联。

3、标的公司及其董事、监事、高管人员买卖七星电子股票情况：

北方微电子财务总监李秋林买卖公司股票情况如下：

姓名	证券简称	累计买入（股）	累计卖出（股）	截至目前结余股数（股）
李秋林	七星电子	0	2,000	0

根据李秋林所作说明并经核查，李秋林没有参与本次重大资产重组的决策过程，亦不知悉任何未公开披露的有关七星电子本次重大资产重组的内容和信息，不属于相关法律法规及规范性文件规定的内幕信息的知情人员。李秋林的上述持有、买卖“七星电子”挂牌交易 A 股股票行为系在并未获知任何本次七星电子重大资产重组有关信息的情况下，基于对二级市场交易情况和个人独立判断而进行的投资决策，与本次重组无关联。

除上述已披露的情况外，其他自查范围内人员不存在自查期间买卖七星电子股票的情况。

综上所述，本所律师认为：

（1）在自查期间内，上述人员持有或买卖七星电子股票的行为不构成内幕交易，不存在利用内幕消息买卖“七星电子”股票的情况。

（2）在核查期间内，除上述已披露的信息披露义务人持有或买卖“七星电子”股票的情况，不存在其他信息披露义务人持有或买卖“七星电子”股票的情况。

十一、本次重组的证券服务机构

根据证券服务机构提供的资料并经核查，参与本次重组的证券服务机构的相关情况如下：

证券服务机构类别	证券服务机构名称	证券服务机构资格证书
独立财务顾问	中信建投证券股份有限公司	持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》，获准从事证券投资咨询业务
法律顾问	北京金诚同达律师事务所	持有北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》
审计机构	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	持有财政部与中国证监会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
评估机构	北京亚超资产评估有限公司	持有财政部与中国证监会联合颁发的《证券期货相关业务评估资格证书》

经核查，本所律师认为，参与本次重组的证券服务机构具有为本次重组提供证券服务的资格。

十二、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）七星电子本次重组方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

（二）发行人及本次重组各方具有完全民事权利能力和民事行为能力，具备实施本次重组的主体资格。

（三）截至本法律意见书出具之日，本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准或授权程序，所取得的相关批准和授权合法有效。

（四）本次重组涉及的相关合同和协议具有法律、法规和规范性文件所规定的必备条款，内容合法，在约定的生效条件成就时生效，对协议各方具有法律约束力。

（五）本次重组涉及的标的资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在质押或其他重大权利限制的情形；交易对方以其持有相关标的资产认购七星电子非公开发行的股份不存在法律障碍。

（六）本次重组的标的资产是标的公司股权，不涉及标的公司债权债务的转移或处置，标的公司原有的债权债务仍由本次重组后的标的公司享有或承担；本次重组不存在侵害相关方利益的情形。

（七）截至本法律意见书出具之日，七星电子已履行了现阶段应履行的法定信息披露义务。

（八）本次重组符合《重组办法》和相关规范性文件规定的原则和实质性条件。

（九）参与本次重组的证券服务机构具有为本次重组提供证券服务的资格。

（十）本次重组符合《重组办法》和相关规范性文件规定的原则和实质性条件，不存在实质性法律障碍，不存在可能对本次重组构成重大不利影响的法律问题和风险。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本一式肆份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》签字页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

经办律师：（签字）

贺宝银：_____

贺 维：_____

赵力峰：_____

年 月 日

附件一：

北方微电子专利权情况

一、国内发明专利（566项）

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利权人
1	一种硅片卸载工艺	ZL200510126300.5	2005.12.05	北方微电子
2	减小微沟道效应的多晶硅刻蚀工艺	ZL200410087100.9	2004.10.28	北方微电子
3	一种用于半导体处理的反应室	ZL200510126373.4	2005.12.08	北方微电子
4	控制静电卡盘温度系统	ZL200510126350.3	2005.12.07	北方微电子
5	减少薄膜式电容真空规零点漂移的装置及其方法	ZL200510126344.8	2005.12.07	北方微电子
6	静电卡盘	ZL200510126348.6	2005.12.07	北方微电子
7	一种硅片工艺试验方法	ZL200510126382.3	2005.12.08	北方微电子
8	下抽气式刻蚀装置	ZL200510126353.7	2005.12.07	北方微电子
9	一种控制晶片上的直流偏压的装置	ZL200510130653.2	2005.12.16	北方微电子
10	顶针装置	ZL200510126355.6	2005.12.07	北方微电子
11	一种电极组件及应用该电极组件的等离子体处理设备	ZL200810227983.7	2008.12.03	北方微电子
12	等离子体装置排气环	ZL200710179040.7	2007.12.10	北方微电子
13	等离子体化学气相沉积设备的载板传输控制方法及系统	ZL201010195683.2	2010.06.01	北方微电子
14	一种生产线设备的计时控制方法及装置	ZL201010161304.8	2010.04.28	北方微电子
15	一种晶体硅太阳能电池	ZL200910090149.2	2009.07.29	北方微电子
16	等离子装置工艺腔预处理的方法	ZL200810240867.9	2008.12.24	北方微电子
17	薄膜太阳能电池吸收层的制备方法	ZL200910079876.9	2009.03.13	北方微电子
18	匹配方法及应用该匹配方法的等离子体装置	ZL200810117344.5	2008.07.29	北方微电子
19	一种加热方法、装置及基片处理设备	ZL200910087117.7	2009.06.11	北方微电子
20	反应腔室和内衬装置	ZL200910087929.1	2009.06.25	北方微电子
21	一种等离子体处理设备及方法	ZL200910093054.6	2009.09.22	北方微电子

22	一种阻抗匹配器及等离子体处理设备	ZL200910089112.8	2009.08.03	北方微电子
23	硅太阳能电池的制造方法	ZL200810225065.0	2008.10.27	北方微电子
24	等离子体处理装置及其屏蔽环	ZL200810102094.8	2008.03.17	北方微电子
25	一种基片处理设备及其顶针升降装置	ZL200910088744.2	2009.07.10	北方微电子
26	一种基片处理系统及其机械手臂装置	ZL200910242381.3	2009.12.15	北方微电子
27	一种半导体制程中的干法清洗方法	ZL200710178788.5	2007.12.05	北方微电子
28	一种基片处理设备及其顶针升降装置	ZL200910089525.6	2009.07.22	北方微电子
29	生产线设备的加热控制方法及装置	ZL200910241956.X	2009.12.16	北方微电子
30	一种生产线设备的工艺任务调度方法及装置	ZL201010184990.0	2010.05.20	北方微电子
31	一种阻抗调节装置和包含该装置的阻抗匹配系统	ZL200910238279.6	2009.11.24	北方微电子
32	射频匹配方法及等离子体处理设备	ZL200810116573.5	2008.07.11	北方微电子
33	磁控管装置	ZL200910091688.8	2009.08.28	北方微电子
34	一种工艺终点控制方法和装置	ZL201010584634.8	2008.01.22	北方微电子
35	一种硅片的刻蚀方法	ZL200910236244.9	2009.10.23	北方微电子
36	一种步进电机的丢步检验方法、装置及一种阻抗匹配器	ZL200910243636.8	2009.12.18	北方微电子
37	用于等离子体加工设备的反应腔室和等离子体加工设备	ZL200910242826.8	2009.12.17	北方微电子
38	一种深硅刻蚀工艺	ZL200910089819.9	2009.07.24	北方微电子
39	一种用于半导体工艺设备的衬套机构及其制造方法	ZL200810100895.0	2008.02.25	北方微电子
40	工艺数据监控方法、装置及系统	ZL201010278844.4	2010.09.09	北方微电子
41	一种工艺控制的方法和装置	ZL200810239833.8	2008.12.12	北方微电子
42	一种用于中、低频等离子体加工设备的电极板和反应腔室	ZL200910238675.9	2009.11.30	北方微电子
43	生产线设备载板数量的配置方法及装置	ZL200910238730.4	2009.11.23	北方微电子
44	等离子体增强化学气相沉积装置	ZL201010225093.X	2010.07.02	北方微电子
45	具有故障诊断功能的控制系统和方法	ZL200910079035.8	2009.03.03	北方微电子
46	一种等离子体处理设备、方法及腔室清洗	ZL200910090764.3	2009.08.10	北方微电子

	方法			
47	一种补偿直流自偏压的系统和方法	ZL200910077914.7	2009.02.03	北方微电子
48	一种减反射膜及其制备方法	ZL200910082424.6	2009.04.16	北方微电子
49	一种基片处理系统及其机械手臂装置	ZL200910241497.5	2009.12.10	北方微电子
50	升降装置及具有该装置的半导体器件加工设备	ZL201010110583.5	2010.02.09	北方微电子
51	喷嘴及反应腔室	ZL200710178735.3	2007.12.04	北方微电子
52	一种靶材及应用该靶材的半导体器件加工设备	ZL201010177298.5	2010.05.17	北方微电子
53	气体输入装置和半导体加工设备	ZL200910086605.6	2009.06.12	北方微电子
54	一种等离子体处理设备及其顶针升降装置	ZL200910085515.5	2009.05.25	北方微电子
55	一种加热装置及应用该加热装置的等离子体处理设备	ZL200910087118.1	2009.06.11	北方微电子
56	静电卡盘装置及其温度控制方法	ZL200810224801.0	2008.10.21	北方微电子
57	一种位置校准系统及等离子体处理装置	ZL201010125243.X	2010.03.12	北方微电子
58	一种选择性发射极太阳能电池的制备方法	ZL200910237945.4	2009.11.19	北方微电子
59	一种静电卡盘及其残余电荷的消除方法	ZL200910235680.4	2009.10.12	北方微电子
60	腔室窗及等离子体工艺腔室	ZL200810226478.0	2008.11.12	北方微电子
61	一种电感耦合装置及应用该装置的等离子体处理设备	ZL201010216936.X	2010.06.23	北方微电子
62	一种半导体加工装置以及用于该装置中的喷嘴结构	ZL200810111922.4	2008.05.19	北方微电子
63	耦合窗的温度测量装置、等离子体设备及温度测量方法	ZL201010221045.3	2010.06.29	北方微电子
64	一种阻抗匹配方法及等离子体处理设备	ZL200910089815.0	2009.07.24	北方微电子
65	大气传输腔室及其内部气流改变方法、等离子体处理设备	ZL200910238402.4	2009.11.19	北方微电子
66	等离子体处理设备及其静电卡盘装置	ZL200910076480.9	2009.01.04	北方微电子
67	半导体加工设备的供气系统及其气体流量校准的方法	ZL200710120360.5	2007.08.16	北方微电子
68	一种非晶硅薄膜太阳能电池及制备方法	ZL200910237865.9	2009.11.12	北方微电子
69	深硅刻蚀方法、等离子体加工方法和系统	ZL200910089174.9	2009.08.03	北方微电子

70	一种等离子体加工设备	ZL200810240162.7	2008.12.18	北方微电子
71	一种等离子体加工设备及用于该设备中反应腔室的加热装置	ZL200910243530.8	2009.12.25	北方微电子
72	一种排气板及等离子体处理设备	ZL201010159101.5	2010.04.26	北方微电子
73	一种生产线设备的温度监控方法及装置	ZL200910090172.1	2009.07.29	北方微电子
74	一种半导体晶片举升装置	ZL200810057403.4	2008.02.01	北方微电子
75	传输腔室的压强控制方法、装置及等离子体设备	ZL201010530089.4	2010.10.29	北方微电子
76	等离子体加工设备	ZL201010178125.5	2010.05.14	北方微电子
77	一种 PECVD 系统	ZL200910241478.2	2009.12.03	北方微电子
78	一种载板回收控制方法、系统及一种薄膜沉积设备、方法	ZL201010234877.9	2010.07.21	北方微电子
79	光刻胶的去除方法	ZL200910241611.4	2009.11.27	北方微电子
80	半导体工艺中的过程控制方法及系统	ZL201010540104.3	2010.11.10	北方微电子
81	电极结构及等离子体设备	ZL200910086630.4	2009.06.12	北方微电子
82	具有穿孔零件的镀膜工艺及设备	ZL200910235662.6	2009.10.10	北方微电子
83	一种中、低频等离子体加工设备和电极板	ZL201010197959.0	2010.06.03	北方微电子
84	用于等离子体加工设备的电极板和清除工艺沉积物的方法	ZL200910242684.5	2009.12.14	北方微电子
85	一种支撑装置及应用该装置的等离子体处理设备	ZL200910241850.X	2009.12.10	北方微电子
86	功率比例调节器和调节方法、电感耦合等离子体发生装置	ZL201010195786.9	2010.06.01	北方微电子
87	工艺数据分析方法和系统	ZL201010520658.7	2010.10.20	北方微电子
88	PVD 设备及采用该 PVD 设备进行晶片处理的方法	ZL201010606451.1	2010.12.24	北方微电子
89	用于半导体器件加工设备的升降装置及加工设备	ZL200910243966.7	2009.12.28	北方微电子
90	真空加工设备及其温度控制方法、半导体器件加工方法	ZL201010258020.0	2010.08.19	北方微电子
91	一种调整电流分配的方法、装置及等离子体处理设备	ZL200910084461.0	2009.05.14	北方微电子

92	一种单晶硅绒面结构的制备方法	ZL201010154626.X	2010.04.26	北方微电子
93	工厂自动化系统的数据同步方法和工厂自动化系统	ZL201010586293.8	2010.12.08	北方微电子
94	电机控制装置、方法、阻抗匹配器及等离子体处理设备	ZL200910241940.9	2009.12.16	北方微电子
95	均热板及应用该均热板的基片处理设备	ZL201010585727.2	2010.12.06	北方微电子
96	一种等离子体刻蚀工艺的终点检测方法	ZL200510002965.5	2005.01.27	北方微电子
97	一种半导体刻蚀前去除颗粒的工艺	ZL200510126285.4	2005.12.02	北方微电子
98	气体注入及扩散系统	ZL200510126378.7	2005.12.08	北方微电子
99	一种刻蚀设备的射频起辉控制方法	ZL200510126351.8	2005.12.07	北方微电子
100	一种去除刻蚀工艺后硅片表面颗粒的等离子体清洗方法	ZL200510126280.1	2005.12.02	北方微电子
101	半导体加工系统反应腔室	ZL200510130734.2	2005.12.26	北方微电子
102	一种去除暴露区域聚合物的解吸附工艺	ZL200510126279.9	2005.12.02	北方微电子
103	一种栅刻蚀的方法	ZL200510126266.1	2005.12.02	北方微电子
104	一种等离子体激励方法	ZL200510126395.0	2005.12.08	北方微电子
105	一种多晶硅栅刻蚀终点的检测装置	ZL200510002964.0	2005.01.27	北方微电子
106	静电卡盘	ZL200510126383.8	2005.12.08	北方微电子
107	促进晶片刻蚀均匀的静电卡盘	ZL200510130651.3	2005.12.16	北方微电子
108	一种半导体晶片加工的传输平台	ZL200510130649.6	2005.12.16	北方微电子
109	气动式平台开盖机构	ZL200510126403.1	2005.12.08	北方微电子
110	用于半导体设备具有调节长度功能的举升装置	ZL200510126387.6	2005.12.08	北方微电子
111	一种能够消除残气影响的多晶硅刻蚀工艺	ZL200510126340.X	2005.12.07	北方微电子
112	真空机械手	ZL200510126404.6	2005.12.08	北方微电子
113	平台开盖机构	ZL200510126402.7	2005.12.08	北方微电子
114	一种减少颗粒产生的多晶硅栅极刻蚀工艺	ZL200510126381.9	2005.12.08	北方微电子
115	等离子体刻蚀装置排气环	ZL200510126354.1	2005.12.07	北方微电子
116	一种在晶片刻蚀设备中彻底释放静电卡盘静电的方法	ZL200510126454.4	2005.12.09	北方微电子

117	等离子体刻蚀装置	ZL200510126304.3	2005.12.05	北方微电子
118	静电卡盘安装拆卸工具	ZL200510126277.X	2005.12.02	北方微电子
119	一种防止多晶硅刻蚀中器件等离子损伤的刻蚀工艺	ZL200510126275.0	2005.12.02	北方微电子
120	用于半导体设备的下电极组件	ZL200510126388.0	2005.12.08	北方微电子
121	一种半导体设备中的工艺过程的异常监测方法	ZL200510126448.9	2005.12.09	北方微电子
122	避免沟槽底部毛边生成的多晶硅刻蚀工艺	ZL200410087099.X	2004.10.28	北方微电子
123	一种电感耦合等离子体装置	ZL200510064592.4	2005.04.15	北方微电子
124	提高深亚微米多晶硅栅刻蚀均匀性的方法	ZL200410062489.1	2004.07.12	北方微电子
125	一种栅刻蚀工艺	ZL200510126265.7	2005.12.02	北方微电子
126	具有视觉传感器的硅片运输系统及传输方法	ZL200510126437.0	2005.12.09	北方微电子
127	一种多晶硅刻蚀中的干法清洗工艺	ZL200510126458.2	2005.12.09	北方微电子
128	一种去除多晶硅刻蚀工艺中残留聚合物的方法	ZL200510126276.5	2005.12.02	北方微电子
129	增进流场均匀性的屏蔽板	ZL200510126394.6	2005.12.08	北方微电子
130	一种石英盖定位保护装置	ZL200510126297.7	2005.12.05	北方微电子
131	一种硅栅刻蚀的方法	ZL200510126288.8	2005.12.02	北方微电子
132	一种减小等离子损伤的刻蚀工艺	ZL200510126287.3	2005.12.02	北方微电子
133	一种消除刻蚀工艺过程中残余气体的控制方法	ZL200510126380.4	2005.12.08	北方微电子
134	一种减少干法清洗工艺对刻蚀均匀性影响的方法	ZL200510126286.9	2005.12.02	北方微电子
135	等离子反应室	ZL200510126278.4	2005.12.02	北方微电子
136	一种硅片卸载工艺	ZL200510126284.X	2005.12.02	北方微电子
137	一种减少等离子损伤的硅片卸载工艺	ZL200510126273.1	2005.12.02	北方微电子
138	一种气体温度可控的等离子体刻蚀装置	ZL200510126272.7	2005.12.02	北方微电子
139	一种基片处理设备	ZL201110171217.5	2011.06.23	北方微电子
140	腔室装置和基片处理设备	ZL201110147138.0	2011.06.01	北方微电子
141	用于晶片的测试分选设备	ZL201110132754.9	2011.05.20	北方微电子

142	化学气相沉积反应腔装置及具有其的化学气相沉积设备	ZL201110120569.8	2011.05.10	北方微电子
143	进气环、进气组件、工艺腔装置和 CVD 设备	ZL201110118979.9	2011.05.09	北方微电子
144	片盒定位机构和具有该片盒定位机构的腔室装置	ZL201110115912.X	2011.05.05	北方微电子
145	溅射腔室、预清洗腔室以及等离子体加工设备	ZL201110099424.4	2011.04.20	北方微电子
146	托盘及具有其的化学气相沉积设备	ZL201110094076.1	2011.04.14	北方微电子
147	腔室装置和具有它的基片处理设备	ZL201110088702.6	2011.04.08	北方微电子
148	磁极组件及具有它的磁控管、溅射室装置和基片处理设备	ZL201110084073.X	2011.04.02	北方微电子
149	执行装置和机械手	ZL201110082395.0	2011.04.01	北方微电子
150	一种静电吸附载板、制膜设备及薄膜制备工艺	ZL201110078433.5	2011.03.30	北方微电子
151	托盘装置及结晶膜生长设备	ZL201110059870.2	2011.03.11	北方微电子
152	步进电机的控制方法、装置及阻抗匹配器	ZL201110021619.7	2011.01.19	北方微电子
153	一种气体输送系统及应用该系统的半导体处理设备	ZL201110004923.0	2011.01.11	北方微电子
154	感应耦合等离子体装置	ZL201010590661.6	2010.12.15	北方微电子
155	物理气相沉积设备及磁控溅射方法	ZL201010528478.3	2010.10.27	北方微电子
156	等离子体增强化学气相沉积设备	ZL201010616317.X	2010.12.30	北方微电子
157	磁控源，磁控溅射设备和磁控溅射方法	ZL201010613102.2	2010.12.29	北方微电子
158	半导体设备	ZL201010610649.7	2010.12.17	北方微电子
159	步进电机的控制方法和装置、匹配器及等离子体加工设备	ZL201010600930.2	2010.12.13	北方微电子
160	界面编辑方法及装置	ZL201010594583.7	2010.12.17	北方微电子
161	控制传送的方法和装置、以及传送装置和加工设备	ZL201010591792.6	2010.12.08	北方微电子
162	金属有机化合物化学气相沉积设备	ZL201010586605.5	2010.12.13	北方微电子
163	射频匹配方法及装置、等离子体设备	ZL201010585583.0	2010.12.10	北方微电子
164	设备控制装置和方法	ZL201010584081.6	2010.12.10	北方微电子

165	一种载板清洗方法、装置及基片镀膜设备	ZL201010579610.3	2010.12.03	北方微电子
166	刻蚀残留的检测方法和系统、谱线模型的建立方法和系统	ZL201010532664.4	2010.11.01	北方微电子
167	一种直线驱动装置及应用该装置的半导体处理设备	ZL201010532049.3	2010.10.29	北方微电子
168	托盘及具有其的晶片处理设备	ZL201010291676.2	2010.09.26	北方微电子
169	机械卡盘及刻蚀机	ZL201010284754.6	2010.09.15	北方微电子
170	薄膜加工设备的下极板及应用该下极板的等离子体加工设备	ZL201010230733.6	2010.07.13	北方微电子
171	一种磁控管及应用该磁控管的薄膜沉积处理设备	ZL201010224956.1	2010.07.02	北方微电子
172	一种埋栅太阳能电池的制备方法	ZL201010154631.0	2010.04.26	北方微电子
173	反应腔室及化学气相沉积设备	ZL200910086629.1	2009.06.12	北方微电子
174	电感耦合等离子体装置	ZL200710120362.4	2007.08.16	北方微电子
175	用于驱动磁控管的扫描机构、磁控源和磁控溅射设备	ZL201110452828.7	2011.12.28	北方微电子
176	磁控源和磁控溅射设备	ZL201110343552.9	2011.11.03	北方微电子
177	一种上电极及应用该上电极的等离子体加工设备	ZL201110303332.3	2011.09.30	北方微电子
178	一种提高各向异性的多晶硅脉冲刻蚀工艺	ZL200510126274.6	2005.12.02	北方微电子
179	一种能够避免微沟槽现象的硅栅刻蚀工艺	ZL200510126299.6	2005.12.05	北方微电子
180	一种在晶片刻蚀工艺中控制关键尺寸偏差的方法	ZL200510126450.6	2005.12.09	北方微电子
181	等离子体刻蚀装置	ZL200510126341.4	2005.12.07	北方微电子
182	具有流量控制的平台真空气路系统及其控制方法	ZL200510126401.2	2005.12.08	北方微电子
183	气流分布均匀的刻蚀装置	ZL200510130652.8	2005.12.16	北方微电子
184	一种静电卡盘	ZL200510126384.2	2005.12.08	北方微电子
185	一种真空锁过渡腔室	ZL200510126399.9	2005.12.08	北方微电子
186	等离子体反应装置	ZL200510126346.7	2005.12.07	北方微电子
187	一种将硅片的中心放置在静电卡盘中心的方法	ZL200512126439.X	2005.12.09	北方微电子

188	等离子体反应室温控系统在线故障检测装置及其方法	ZL200510126268.0	2005.12.02	北方微电子
189	一种能够防止器件等离子体损伤的多晶硅刻蚀工艺	ZL200510126369.8	2005.12.08	北方微电子
190	一种检测刻蚀机气路柜漏率的方法	ZL200510126444.0	2005.12.09	北方微电子
191	静电卡盘	ZL200510126302.4	2005.12.05	北方微电子
192	一种等离子处理线圈	ZL200510126379.1	2005.12.08	北方微电子
193	一种硅片脱附工艺	ZL200510126377.2	2005.12.08	北方微电子
194	单进气双区可调喷嘴	ZL200510126442.1	2005.12.09	北方微电子
195	一种晶片刻蚀工艺中的故障检测方法	ZL200510126441.7	2005.12.09	北方微电子
196	晶片举升装置及举升方法	ZL200510126436.6	2005.12.09	北方微电子
197	一种可调整局部耦合强度的 ICP 线圈	ZL200510126283.5	2005.12.02	北方微电子
198	半导体制造设备控制系统及其方法	ZL200510126398.4	2005.12.08	北方微电子
199	刻蚀机集群控制器与工艺模块控制器通讯系统及方法	ZL200610011316.6	2006.02.09	北方微电子 清华大学
200	光刻胶修整方法	ZL200410062491.9	2004.07.12	北方微电子
201	电感耦合线圈	ZL200510126298.1	2005.12.05	北方微电子
202	用于半导体抽真空设备拆装的装置及其方法	ZL200510126308.1	2005.12.05	北方微电子
203	刻蚀机集群控制器	ZL200610011922.8	2006.05.17	北方微电子 清华大学
204	可分区控温的静电卡盘系统	ZL200510126349.0	2005.12.07	北方微电子
205	一种质量流量控制器在线校验的方法	ZL200510126345.2	2005.12.07	北方微电子
206	一种半导体刻蚀设备中控制分子泵的方法	ZL200510126375.3	2005.12.08	北方微电子
207	基于 Web 服务的工厂主机与集群控制器系统的控制方法	ZL200510126386.1	2005.12.08	北方微电子
208	一种半导体加工数据的处理方法	ZL200510126371.5	2005.12.08	北方微电子
209	一种半导体刻蚀工艺中控制反应腔室晶片温度的方法	ZL200510126376.8	2005.12.08	北方微电子
210	具有 CCD 传感器的硅片传输系统及传输方法	ZL200510126438.5	2005.12.09	北方微电子

211	一种利用滤波器抑制抖振的方法	ZL200510126385.7	2005.12.08	北方微电子
212	气体流量控制装置校验的方法	ZL200610114468.9	2006.11.10	北方微电子
213	一种半导体刻蚀装置	ZL200510126390.8	2005.12.08	北方微电子
214	一种晶片刻蚀设备的取片传输方法	ZL200510126440.2	2005.12.09	北方微电子
215	一种晶片刻蚀设备的气路控制方法	ZL200510126455.9	2005.12.09	北方微电子
216	刻蚀设备的控温装置及其控制晶片温度的方法	ZL200610112568.8	2006.08.23	北方微电子
217	气体流量校准的方法	ZL200610114417.6	2006.11.09	北方微电子
218	定位校准装置及定位校准系统	ZL200610112569.2	2006.08.23	北方微电子
219	一种真空腔室的充气系统	ZL200510126400.8	2005.12.08	北方微电子
220	真空获得系统	ZL200610112748.6	2006.08.31	北方微电子
221	一种硅片刻蚀工艺处方的控制方法	ZL200510126446.X	2005.12.09	北方微电子
222	用于静电卡盘的信号传输装置	ZL200510126443.6	2005.12.09	北方微电子
223	一种等离子体反应室控制系统组装箱	ZL200510126338.2	2005.12.07	北方微电子
224	一种抽真空阀门控制装置	ZL200510126264.2	2005.12.02	北方微电子
225	个性化工厂设备控制系统	ZL200510126452.5	2005.12.09	北方微电子
226	一种半导体设备中气体校准的方法	ZL200510126453.X	2005.12.09	北方微电子
227	一种半导体刻蚀设备的腔室清洗方法	ZL200510126307.7	2005.12.05	北方微电子
228	蚀刻设备在线故障诊断的方法	ZL200610112567.3	2006.08.23	北方微电子
229	一种设备报警与互锁处理方法	ZL200510126296.2	2005.12.05	北方微电子
230	一种多晶硅刻蚀的方法	ZL200610165336.9	2006.12.18	北方微电子
231	硅片刻蚀方法	ZL200610113756.2	2006.10.13	北方微电子
232	气体注射装置	ZL200610113334.5	2006.09.22	北方微电子
233	举升装置及调整举升装置平面度的方法	ZL200610113333.0	2006.09.22	北方微电子
234	一种半导体刻蚀设备的控制方法	ZL200610113203.7	2006.09.19	北方微电子
235	传输腔室	ZL200610112977.8	2006.09.13	北方微电子
236	气体注射装置	ZL200610112976.3	2006.09.13	北方微电子
237	多晶硅刻蚀的方法	ZL200610165226.2	2006.12.14	北方微电子
238	一种去除附着于石英零件表面聚合物薄膜	ZL200510126270.8	2005.12.02	北方微电子

	的清洗方法			
239	一种去除附着于氧化钇零件表面聚合物薄膜的清洗方法	ZL200510126271.2	2005.12.02	北方微电子
240	电感耦合线圈及其电感耦合等离子体装置	ZL200510002966.X	2005.01.27	北方微电子
241	电感耦合线圈及其电感耦合等离子体装置	ZL200510008776.9	2005.02.25	北方微电子
242	去除刻蚀后聚合物的单片清洗方法	ZL200510126305.8	2005.12.05	北方微电子
243	气体注射装置	ZL200610114205.8	2006.11.01	北方微电子
244	硅片浅沟槽隔离刻蚀的方法	ZL200610114322.4	2006.11.06	北方微电子
245	硅片加工过程中的调度方法	ZL200610114469.3	2006.11.10	北方微电子
246	开盖装置	ZL200610164849.8	2006.12.06	北方微电子
247	气体分布装置	ZL200610164845.X	2006.12.06	北方微电子
248	硅片浅沟槽隔离刻蚀的方法	ZL200610165127.4	2006.12.13	北方微电子
249	一种消除双作用气缸换向抖动的控制装置	ZL200610165298.7	2006.12.15	北方微电子
250	硅化钨硅片刻蚀的方法	ZL200610165407.5	2006.12.19	北方微电子
251	气体分布控制系统及多晶硅栅极刻蚀与硅片浅沟槽隔离刻蚀的方法	ZL200610162288.8	2006.12.19	北方微电子
252	压力控制系统	ZL200610113002.7	2006.09.06	北方微电子
253	气体注射装置	ZL200610164848.3	2006.12.06	北方微电子
254	一种新型质量流量控制器在线校验设备	ZL200510126343.3	2005.12.07	北方微电子
255	一种半导体制造工艺事件的自动处理装置和方法	ZL200510126372.X	2005.12.08	北方微电子
256	一种多晶硅刻蚀工艺中的颗粒控制方法	ZL200510126370.0	2005.12.08	北方微电子
257	工厂设备子系统通信方法及其装置	ZL200510126451.0	2005.12.09	北方微电子
258	一种等离子刻蚀设备的刻蚀终点检测装置与方法	ZL200710062687.1	2007.01.12	北方微电子
259	一种反应腔室压力控制的装置和方法	ZL200610114244.8	2006.11.02	北方微电子
260	等离子体处理设备、气体分配装置以及气体输送方法	ZL200810118805.0	2008.08.22	北方微电子
261	进气喷嘴	ZL200510126347.1	2005.12.07	北方微电子
262	一种去除附着于阳极氧化铝零件表面聚合物薄膜的清洗方法	ZL200510126269.5	2005.12.02	北方微电子

263	一种阳极氧化零件表面的清洗方法	ZL200610165559.5	2006.12.21	北方微电子
264	清洗硅片刻蚀腔室的方法	ZL200610165562.7	2006.12.21	北方微电子
265	反应腔室内衬及包含该内衬的反应腔室	ZL200610164847.9	2006.12.06	北方微电子
266	一种射频系统的控制方法及其射频匹配器	ZL200510126449.3	2005.12.09	北方微电子
267	一种石英材料零件的清洗方法	ZL200610165561.2	2006.12.21	北方微电子
268	半导体刻蚀设备中传输模块实现告警的方法及装置	ZL200610114204.3	2006.11.01	北方微电子
269	一种微电子刻蚀系统中受控部件的异常监测装置及方法	ZL200610113335.X	2006.09.22	北方微电子
270	气体注入装置	ZL200710063311.2	2007.01.08	北方微电子
271	硅片刻蚀设备	ZL200710063394.5	2007.01.10	北方微电子
272	硅片传输设备的控制系统及方法	ZL200710062729.1	2007.01.15	北方微电子
273	一种举升装置	ZL200710121869.1	2007.09.17	北方微电子
274	一种晶片夹持装置	ZL200710121040.1	2007.08.29	北方微电子
275	干涉光检测装置及校准该装置的方法	ZL200610169567.7	2006.12.22	北方微电子
276	一种阻抗匹配的方法及阻抗匹配装置	ZL200710062686.7	2007.01.12	北方微电子
277	一种检测半导体晶片从静电卡盘上释放程度的方法	ZL200710062688.6	2007.01.12	北方微电子
278	一种多晶硅刻蚀腔室中陶瓷材料零件表面的清洗方法	ZL200710062733.8	2007.01.15	北方微电子
279	一种等离子刻蚀工艺的预测与监控方法	ZL200710062847.2	2007.01.18	北方微电子
280	反应腔室内衬及包含该内衬的反应腔室	ZL200610164984.2	2006.12.11	北方微电子
281	在线预测刻蚀设备维护的方法	ZL200610113143.9	2006.09.15	北方微电子
282	硅片传输过程的调度方法	ZL200710062728.7	2007.01.15	北方微电子
283	反应腔室清洗的方法	ZL200610164902.4	2006.12.07	北方微电子
284	检测反应腔室内等离子体分布密度的方法	ZL200610169568.1	2006.12.22	北方微电子
285	一种互锁和报警的处理方法及系统	ZL200710175448.7	2007.09.29	北方微电子
286	等离子体处理装置及其介质窗	ZL200710179806.1	2007.12.18	北方微电子
287	一种用于半导体设备的直流电极	ZL200710175746.6	2007.10.11	北方微电子
288	一种控制晶片偏压的装置和方法	ZL200710121395.0	2007.09.05	北方微电子

289	一种静电夹盘	ZL200710121039.9	2007.08.29	北方微电子
290	排气装置及包含该排气装置的反应腔室	ZL200610169563.9	2006.12.22	北方微电子
291	电感耦合源	ZL200510126396.5	2005.12.08	北方微电子
292	晶片处理室的内衬及包含该内衬的晶片处理室	ZL200610113918.2	2006.10.20	北方微电子
293	电感耦合线圈及电感耦合等离子体装置	ZL200610112658.7	2006.08.28	北方微电子
294	硅片蚀刻方法	ZL200610113204.1	2006.09.19	北方微电子
295	搬运校准装置及应用该装置的晶片传输系统	ZL200610113367.X	2006.09.25	北方微电子
296	一种促进半导体晶片上静电电荷消散的方法	ZL200710062689.0	2007.01.12	北方微电子
297	一种去除半导体零件表面污染物的方法	ZL200710063226.6	2007.01.04	北方微电子
298	硅片刻蚀的方法	ZL200610164844.5	2006.12.06	北方微电子
299	腔室上盖及包含该上盖的反应腔室	ZL200610165461.X	2006.12.20	北方微电子
300	一种解决半导体硅刻蚀工艺偏移的方法	ZL200710063232.1	2007.01.04	北方微电子
301	内衬及包含该内衬的反应腔室	ZL200610165334.X	2006.12.18	北方微电子
302	一种气体分配装置及应用该分配装置的等离子体处理设备	ZL200810118448.8	2008.08.22	北方微电子
303	一种气体分配装置及采用该气体分配装置的等离子体处理设备	ZL200810116796.1	2008.07.17	北方微电子
304	硅片脱附的方法	ZL200710062731.9	2007.01.15	北方微电子
305	一种多晶硅刻蚀腔室中阳极氧化零件表面的清洗方法	ZL200710063231.7	2007.01.04	北方微电子
306	控制双作用气缸活塞移动速度的装置	ZL200710063228.5	2007.01.04	北方微电子
307	一种光电开关动态调整硅片偏差的方法及装置	ZL200710063221.3	2007.01.04	北方微电子
308	一种气体分配装置及应用该分配装置的半导体处理设备	ZL200810057524.9	2008.02.02	北方微电子
309	一种气路控制方法和装置	ZL200710176552.8	2007.10.30	北方微电子
310	电感耦合线圈及其电感耦合等离子体装置	ZL200510093733.5	2005.08.29	北方微电子
311	一种等离子刻蚀设备的维护方法	ZL200710063229.X	2007.01.04	北方微电子

312	等离子体处理设备及其气体分配装置	ZL200810056179.7	2008.01.14	北方微电子
313	干法蚀刻方法以及硅片蚀刻方法	ZL200810104178.5	2008.04.16	北方微电子
314	一种去除腔室副产物的等离子清洗方法和等离子处理系统	ZL200910082929.2	2009.04.24	北方微电子
315	一种半导体刻蚀设备腔室的清洗方法	ZL200710063224.7	2007.01.04	北方微电子
316	减少半导体基片颗粒污染的方法及系统	ZL200810057751.1	2008.02.15	北方微电子
317	一种快速 RF 自动阻抗匹配方法	ZL200710063223.2	2007.01.04	北方微电子
318	基片承载装置和等离子体加工设备	ZL200810224714.5	2008.12.09	北方微电子
319	质量流量控制器的在线校验方法	ZL200810227447.7	2008.11.25	北方微电子
320	一种射频匹配器的传感器的鉴相装置和方法	ZL200710063284.9	2007.01.05	北方微电子
321	晶片处理室的内衬及包含该内衬的晶片处理室	ZL200610169565.8	2006.12.22	北方微电子
322	硅片角度定位装置及反应腔室	ZL200710120493.2	2007.08.20	北方微电子
323	一种射频匹配器的传感器的鉴相装置和方法	ZL200710063392.6	2007.01.10	北方微电子
324	一种铝材料零件的清洗方法	ZL200610165560.8	2006.12.21	北方微电子
325	一种用于半导体制造工艺中的边缘环机构	ZL200810103065.3	2008.3.31	北方微电子
326	双电极静电卡盘	ZL200710121131.5	2007.08.30	北方微电子
327	一种陶瓷零件表面的清洗方法	ZL200610113455.X	2006.09.28	北方微电子
328	半导体生产设备中的功率控制装置及方法	ZL200610114418.0	2006.11.09	北方微电子
329	摆阀及等离子体加工装置及其控制反应腔室内压力的方法	ZL200710178736.8	2007.12.04	北方微电子
330	一种取值互锁报警的处理方法和装置	ZL200910076959.2	2009.01.14	北方微电子
331	门盖装置和具有门盖装置的真空设备	ZL200810226416.X	2008.11.10	北方微电子
332	一种带有连接层的卡盘装置及其制造方法	ZL200810055963.6	2008.01.03	北方微电子
333	一种工艺控制方法和装置	ZL200710178095.6	2007.11.26	北方微电子
334	进气装置及反应腔室	ZL200710119581.0	2007.07.26	北方微电子
335	精密零件的清洗方法	ZL200710121340.X	2007.09.04	北方微电子
336	被处理体的保持装置及其温度控制方法	ZL200710119106.3	2007.07.13	北方微电子

337	一种气体分配装置及应用该分配装置的半导体处理设备	ZL200810103727.7	2008.04.10	北方微电子
338	一种气体分配装置及应用该分配装置的半导体处理设备	ZL200810104664.7	2008.04.23	北方微电子
339	等离子体处理设备及其基片载板	ZL200810117010.8	2008.07.22	北方微电子
340	半导体加工工艺控制方法	ZL200710121570.6	2007.09.10	北方微电子
341	晶片传输系统	ZL200710121341.4	2007.09.04	北方微电子
342	一种晶片夹持系统及应用该夹持系统的半导体处理设备	ZL200810056386.2	2008.01.17	北方微电子
343	一种用于半导体加工反应腔室的密封结构	ZL200810057930.5	2008.02.21	北方微电子
344	一种等离子体内电子温度测量装置	ZL200510126389.5	2005.12.08	北方微电子
345	连接装置	ZL200610112711.3	2006.08.30	北方微电子
346	静电卡盘装置	ZL200610171547.3	2006.12.30	北方微电子
347	一种工厂自动化接口的实现方法和系统	ZL200710176251.5	2007.10.23	北方微电子
348	等离子体约束装置及应用该约束装置的半导体处理设备	ZL200710177831.6	2007.11.21	北方微电子
349	静电卡盘的测温装置	ZL200710179699.2	2007.12.17	北方微电子
350	一种在线机台异常处理的方法和系统	ZL200910088869.5	2007.07.21	北方微电子
351	一种消除设备模拟量干扰的监测方法和装置	ZL200710063230.2	2007.01.04	北方微电子
352	等离子体处理设备	ZL200810115629.5	2008.06.25	北方微电子
353	一种工艺过程参数的可视化装置和方法	ZL200810240097.8	2008.12.18	北方微电子
354	一种故障检测的方法和系统	ZL200710304377.6	2007.12.27	北方微电子
355	一种阳极氧化零件表面的清洗方法	ZL200610113529.X	2006.09.29	北方微电子
356	一种生产线设备的控制装置及控制系统	ZL200910076960.5	2009.01.14	北方微电子
357	一种半导体传输系统中的真空锁	ZL200810222415.8	2008.09.16	北方微电子
358	静电卡盘	ZL200710118502.4	2007.07.06	北方微电子
359	在线式基板处理系统	ZL200910086527.X	2009.06.05	北方微电子
360	电感耦合线圈及应用该线圈的电感耦合等离子体装置	ZL200610171549.2	2006.12.30	北方微电子
361	半导体加工系统及其保护真空压力敏感元	ZL200710122007.0	2007.09.19	北方微电子

	件的方法			
362	一种被处理体的保持装置	ZL200710304242.X	2007.12.26	北方微电子
363	等离子体处理设备及其基片载板	ZL200810226608.0	2007.11.17	北方微电子
364	深硅刻蚀装置和深硅刻蚀设备的进气系统	ZL200910091856.3	2009.08.27	北方微电子
365	腔室内衬及反应腔室	ZL200710120745.1	2007.08.24	北方微电子
366	一种半导体刻蚀工艺的终点控制方法和装置	ZL200910076958.8	2009.01.14	北方微电子
367	一种阻抗匹配器	ZL200810056600.4	2008.01.22	北方微电子
368	一种工艺终点控制方法和装置	ZL200810056599.5	2008.01.22	北方微电子
369	等离子体约束装置和等离子体加工设备	ZL200810224814.8	2008.10.22	北方微电子
370	一种控制实现方法和系统	ZL200710176653.5	2007.10.31	北方微电子
371	一种数据调度方法及装置	ZL200710179792.3	2007.12.18	北方微电子
372	电感耦合线圈及采用该电感耦合线圈的等离子体处理装置	ZL200810117298.9	2008.07.28	北方微电子
373	大马士革互连工艺中铜金属填充方法	ZL200810118423.8	2008.08.14	北方微电子
374	电感耦合线圈及电感耦合等离子体发生装置	ZL200810057125.2	2008.01.30	北方微电子
375	一种补偿直流自偏压的方法及系统、半导体处理设备	ZL200710304751.2	2007.12.29	北方微电子
376	硅浅槽刻蚀工艺	ZL200710175213.8	2007.09.27	北方微电子
377	气体控温的静电卡盘及其控制基片温度的方法	ZL200710176651.6	2007.10.31	北方微电子
378	一种半导体制程设备零部件的清洗方法	ZL200710177627.4	2007.11.19	北方微电子
379	等离子体处理设备、其气体分配装置及工艺气体提供方法	ZL200810056178.2	2008.01.14	北方微电子
380	一种降低基板处理设备能耗的方法和系统	ZL200910088733.4	2009.07.10	北方微电子
381	一种射频阻抗自动匹配的方法	ZL200810056648.5	2008.01.23	北方微电子
382	控制和促进等离子体起辉的方法	ZL200710175815.3	2007.10.12	北方微电子
383	实现射频阻抗匹配的方法及射频阻抗匹配系统	ZL200710120494.7	2007.08.20	北方微电子 清华大学
384	一种举升装置	ZL200710121870.4	2007.09.17	北方微电子

385	开盖机构及半导体加工设备及其开盖控制方法	ZL200710120746.6	2007.08.24	北方微电子
386	射频自动阻抗匹配方法及射频自动阻抗匹配器	ZL200810056157.0	2008.01.14	北方微电子
387	一种用于半导体处理设备的维护控制方法及系统	ZL200810115660.9	2008.06.26	北方微电子
388	用于减少腔室颗粒沉积的方法、系统及半导体处理设备	ZL200810115418.1	2008.06.23	北方微电子
389	一种多路温控通道控制系统及控制方法	ZL200810101811.5	2008.03.12	北方微电子
390	等离子体处理设备	ZL200810222421.3	2008.09.16	北方微电子
391	等离子体处理设备及其气体分配装置	ZL200910076481.3	2009.01.04	北方微电子
392	平板加热器及等离子体加工设备	ZL200810119172.5	2008.08.28	北方微电子
393	反应腔室	ZL200710120361.X	2007.08.16	北方微电子
394	匹配器及其实现匹配控制的方法	ZL200710119105.9	2007.07.13	北方微电子
395	一种控制射频放电系统直流偏压的装置和方法	ZL200710178857.2	2007.12.06	北方微电子
396	静电卡盘电源电流采样装置及方法及等离子体装置	ZL200810118186.5	2008.08.13	北方微电子
397	反应腔室	ZL200710121288.8	2007.09.03	北方微电子
398	电感耦合线圈及应用该线圈的电感耦合等离子体装置	ZL200710118653.X	2007.07.11	北方微电子
399	提升装置	ZL200610171548.8	2006.12.30	北方微电子
400	一种镀膜工艺控制方法及控制系统	ZL200910087670.0	2009.06.25	北方微电子
401	等离子体处理装置及其屏蔽环	ZL200710178984.2	2007.12.07	北方微电子
402	一种等离子腔室及其温度控制方法	ZL200810118767.9	2008.08.21	北方微电子
403	一种腔室压力控制方法、装置及控制系统	ZL200810224273.9	2008.10.15	北方微电子
404	一种喷嘴装置及应用该喷嘴装置的半导体处理设备	ZL200710176946.3	2007.11.07	北方微电子
405	一种反应腔室及应用该反应腔室的等离子体处理设备	ZL200810119319.0	2008.09.03	北方微电子
406	抽气装置及半导体加工装置	ZL200810225188.4	2008.10.30	北方微电子
407	等离子体处理设备及向其静电卡盘上放置	ZL200910082458.5	2009.04.16	北方微电子

	待加工件的方法			
408	鉴幅传感器及射频传输系统及其对负载阻抗进行鉴幅的方法	ZL200710176232.2	2007.10.23	北方微电子
409	一种生产线设备的监控方法及系统	ZL200910235581.6	2009.09.29	北方微电子
410	一种工艺过程参数的采集方法及系统	ZL200910236047.7	2009.10.19	北方微电子
411	硅太阳能电池的制造方法	ZL200810225491.4	2008.11.03	北方微电子
412	刻蚀装置	ZL200710119400.4	2007.07.23	北方微电子
413	一种太阳能电池制造方法及设备	ZL200810240163.1	2008.12.18	北方微电子
414	一种工艺过程参数的可视化处理方法和装置	ZL200910082770.4	2009.04.29	北方微电子
415	成膜载板及太阳能电池的生产方法	ZL200810239693.4	2008.12.15	北方微电子
416	基片传输装置及其控制系统和控制方法	ZL200810117610.4	2008.08.01	北方微电子
417	电感耦合线圈及电感耦合等离子体装置	ZL200610112570.5	2006.08.23	北方微电子
418	铜阻挡层—籽晶层薄膜制备的方法	ZL200810240829.3	2008.12.24	北方微电子
419	一种监控工艺过程中的异常的方法和系统	ZL200910236037.3	2009.10.16	北方微电子
420	基片偏移的诊断及校正方法和诊断及校正装置	ZL200710179912.X	2007.12.19	北方微电子
421	一种腔室的衬	ZL200710175533.3	2007.09.30	北方微电子
422	生产线设备的控制装置、方法及一种工控机	ZL200910089918.7	2009.07.28	北方微电子
423	反应腔室及半导体加工设备	ZL200810227439.2	2008.11.25	北方微电子
424	一种射频自动阻抗匹配器及其实现方法	ZL200810055642.6	2008.01.04	北方微电子
425	腔室环境的控制方法	ZL200910084869.8	2009.05.19	北方微电子
426	一种腔室状态监控系统、方法以及半导体处理设备	ZL200810105427.2	2008.04.29	北方微电子
427	一种改善半导体制程中加工件背面污染的方法	ZL200710178286.2	2007.11.28	北方微电子
428	等离子体刻蚀装置及栅极的刻蚀方法	ZL200910076699.9	2009.01.15	北方微电子
429	一种匹配器及其匹配方法	ZL200710177433.4	2007.11.15	北方微电子
430	等离子体处理设备及其过渡腔室	ZL200810117009.5	2008.07.22	北方微电子
431	一种电感耦合线圈及等离子体装置	ZL200710179698.8	2007.12.17	北方微电子

432	干法清洗时间的确定方法、装置及等离子体处理设备	ZL200910081451.1	2009.04.07	北方微电子
433	气体分配系统和应用该气体分配系统的半导体处理设备	ZL200710179336.9	2007.12.12	北方微电子
434	机械手及晶片处理系统	ZL200810222607.9	2008.09.18	北方微电子
435	硅栅极的刻蚀方法及提高硅栅极线宽腔室匹配的方法	ZL200810227314.X	2008.11.26	北方微电子
436	背接触太阳能电池的制造方法	ZL200910076264.4	2009.01.08	北方微电子
437	一种举升装置及应用该举升装置的等离子体处理设备	ZL200910082619.0	2009.04.21	北方微电子
438	气体注射装置	ZL200610112659.1	2006.08.28	北方微电子
439	一种机械手调度方法、装置及等离子体处理设备	ZL200810225524.5	2008.11.04	北方微电子
440	接线诊断及纠错方法、装置和多路温控通道控制系统	ZL200810223588.1	2008.10.08	北方微电子
441	基片支承装置及其静电释放方法	ZL200810223308.7	2008.09.25	北方微电子
442	等离子体设备腔室维护前预处理的方法	ZL200910077872.7	2009.01.23	北方微电子
443	等离子体约束装置及等离子体处理装置	ZL200710176174.3	2007.10.22	北方微电子
444	一种在线处理设备	ZL201010198050.7	2010.06.03	北方微电子
445	一种工艺控制方法及控制系统	ZL200910084136.4	2009.05.20	北方微电子
446	等离子体处理设备	ZL200910076479.6	2009.01.04	北方微电子
447	一种半导体等离子刻蚀工艺	ZL200910090173.6	2009.07.29	北方微电子
448	一种集簇设备控制系统和工艺控制系统之间通信的方法	ZL200810056107.2	2008.01.11	北方微电子
449	一种射频传输中实现阻抗匹配的方法和一种阻抗匹配装置	ZL200910243877.2	2009.12.24	北方微电子
450	加热腔室及半导体加工设备	ZL200910081053.X	2009.03.31	北方微电子
451	一种电感耦合线圈及采用该耦合线圈的等离子体处理装置	ZL200810106283.2	2008.05.12	北方微电子
452	一种硅片优化调度的方法和装置	ZL200810239832.3	2008.12.12	北方微电子
453	一种硅片优化调度的方法和装置	ZL200910243876.8	2009.12.24	北方微电子
454	基板冷却方法、基板冷却系统以及基板处	ZL200910085514.0	2009.05.25	北方微电子

	理设备			
455	半导体装置及其制造方法和发光器件	ZL201010225103.X	2010.07.02	北方微电子
456	带有辅助进给装置的进给机构	ZL200710118547.1	2007.07.09	北方微电子
457	一种进气装置及应用该进气装置的半导体处理设备	ZL200710179911.5	2007.12.19	北方微电子
458	一种晶片优化调度的方法和装置	ZL200710179612.1	2007.12.14	北方微电子
459	等离子体处理设备及其射频装置	ZL200810240279.5	2008.12.22	北方微电子
460	一种阻抗匹配器、阻抗匹配方法和等离子体处理系统	ZL200810239148.5	2008.12.10	北方微电子
461	一种报警处理方法及装置	ZL200910243438.1	2009.12.22	北方微电子
462	刻蚀方法	ZL200910076643.3	2009.01.12	北方微电子
463	等离子体加工装置	ZL200910243830.6	2009.12.23	北方微电子
464	一种均光板及应用该均光板的基片加工设备	ZL201010248253.2	2010.08.06	北方微电子
465	传送装置及系统	ZL201010523079.8	2010.10.22	北方微电子
466	磁控源和磁控溅射设备、以及磁控溅射方法	ZL201010538417.5	2010.11.08	北方微电子
467	进气装置和具有它的等离子体化学气相沉积设备	ZL201010562586.2	2010.11.23	北方微电子
468	加热装置及应用该加热装置的基片处理设备	ZL201010591783.7	2010.12.08	北方微电子
469	传输控制方法和装置、及传输装置和电池片加工设备	ZL201010593718.8	2010.12.17	北方微电子
470	金属有机化学气相沉积设备及其腔室组件	ZL201010599492.2	2010.12.21	北方微电子
471	一种基片承载装置及应用该装置的基片处理设备	ZL201010600276.5	2010.12.13	北方微电子
472	用于 PVD 工艺的反应腔室和 PVD 系统	ZL201010603748.2	2010.12.14	北方微电子
473	加热控制方法、装置和系统，加热腔及等离子体设备	ZL201010604798.2	2010.12.23	北方微电子
474	机械手定位装置及传送系统	ZL201010605695.8	2010.12.15	北方微电子
475	工艺数据的获取、存储方法和装置以及工艺数据处理系统	ZL201010608964.6	2010.12.27	北方微电子

476	在基板上形成减反射膜的方法、太阳能电池片及制备方法	ZL201010616540.4	2010.12.30	北方微电子
477	磁控溅射源及磁控溅射设备	ZL201010621854.3	2010.12.24	北方微电子
478	法拉第屏蔽及等离子体加工设备	ZL201010622211.0	2010.12.27	北方微电子
479	磁控管和半导体设备	ZL201110027343.3	2011.01.25	北方微电子
480	工艺腔室装置和具有该工艺腔室装置的外延设备	ZL201110069879.1	2011.03.22	北方微电子
481	反应腔及具有其的化学气相沉积设备	ZL201110093517.6	2011.04.14	北方微电子
482	半导体处理设备	ZL201110097992.0	2011.04.19	北方微电子
483	吸盘、吸盘系统及具有该吸盘的传输系统	ZL201110102222.0	2011.04.22	北方微电子
484	托盘装置及结晶膜生长设备	ZL201110126511.4	2011.05.16	北方微电子
485	硅片的制绒处理方法	ZL201110152787.X	2011.06.08	北方微电子
486	热反射装置及半导体处理设备	ZL201110156346.7	2011.06.10	北方微电子
487	单臂升降装置和双臂升降装置	ZL201110156393.1	2011.06.10	北方微电子
488	一种排气方法、装置及基片处理设备	ZL201110158466.0	2011.06.13	北方微电子
489	静电卡盘和半导体设备	ZL201110220269.7	2011.08.02	北方微电子
490	遮蔽装置及具有其的半导体处理设备	ZL201110234741.2	2011.08.16	北方微电子
491	CVD 反应腔及 CVD 设备	ZL201110249627.7	2011.08.26	北方微电子
492	腔室装置和具有该腔室装置的基片处理设备	ZL201110267850.4	2011.09.08	北方微电子
493	腔室装置和具有它的基片处理设备	ZL201110273597.3	2011.09.15	北方微电子
494	扫描机构、磁控源和磁控溅射设备	ZL201110275874.4	2011.09.16	北方微电子
495	晶圆承载装置及具有它的半导体处理设备	ZL201110338680.4	2011.10.31	北方微电子
496	一种用于驱动磁控管的驱动机构及磁控溅射设备	ZL201110356144.7	2011.11.10	北方微电子
497	基片上料组件、基片装卸载装置和 PECVD 设备	ZL201110393737.0	2011.12.01	北方微电子
498	一种工件定位系统	ZL201110412212.7	2011.12.02	北方微电子
499	一种磁控溅射设备及其工艺方法	ZL201110439653.6	2011.12.23	北方微电子
500	电感耦合等离子体装置	ZL201010532812.2	2010.11.01	北方微电子

501	工艺数据的传送方法、装置和系统	ZL201010537614.5	2010.11.05	北方微电子
502	卡盘和半导体处理装置	ZL201010547525.9	2010.11.16	北方微电子
503	组件开发方法和装置、模拟设备动作的动画显示方法和装置	ZL201010552612.3	2010.11.19	北方微电子
504	工艺数据采集方法、装置及系统	ZL201010582567.6	2010.12.07	北方微电子
505	法拉第屏蔽及等离子体加工设备	ZL201010603743.X	2010.12.14	北方微电子
506	监测报警处理方法、装置及等离子体加工设备	ZL201010610650.X	2010.12.17	北方微电子
507	托盘、腔室装置和外延设备	ZL201110066937.5	2011.03.18	北方微电子
508	等离子体加工设备及其工作方法	ZL201110095456.7	2011.04.15	北方微电子
509	机械手、大气传输单元和晶片传输方法	ZL201110116788.9	2011.05.06	北方微电子
510	一种磁控管、磁控管的制造方法及物理沉积室	ZL201110128880.7	2011.05.18	北方微电子
511	一种静电卡盘及等离子体加工设备	ZL201110175009.2	2011.06.27	北方微电子
512	腔室装置及具有该腔室装置的等离子体处理设备	ZL201110207202.X	2011.07.22	北方微电子
513	一种加热装置及应用该加热装置的等离子体加工设备	ZL201110216867.7	2011.07.29	北方微电子
514	一种图形化蓝宝石衬底的方法和装置	ZL201110225921.4	2011.08.08	北方微电子
515	磁控管、溅射腔室装置和溅射设备	ZL201110233023.3	2011.08.15	北方微电子
516	气流均衡板、腔室装置和基片处理设备	ZL201110281846.3	2011.09.21	北方微电子
517	遮蔽装置、具有其的 PVD 设备及 PVD 设备的控制方法	ZL201110294891.2	2011.09.30	北方微电子
518	一种等离子体预清洗装置	ZL201110299536.4	2011.09.28	北方微电子
519	基板卸载装置和具有它的 PECVD 设备	ZL201110327256.X	2011.10.24	北方微电子
520	一种磁控管及磁控溅射设备	ZL201110430322.6	2011.12.20	北方微电子
521	PVD 设备工艺控制方法和 PVD 设备工艺控制装置	ZL201110439122.7	2011.12.23	北方微电子
522	一种磁控溅射源及磁控溅射设备	ZL201210038271.7	2012.02.20	北方微电子
523	一种进气装置、反应腔室以及等离子体加工设备	ZL201210094362.2	2012.04.01	北方微电子

524	基片装载装置和 PECVD 设备	ZL201210171062.X	2012.05.29	北方微电子
525	抗腐蚀涂层的制作方法、抗腐蚀涂层、等离子体加工设备	ZL201210195700.1	2012.06.14	北方微电子
526	一种磁控溅射源及磁控溅射设备	ZL201010614069.5	2010.12.21	北方微电子
527	等离子体加工设备	ZL200810224715.X	2008.12.09	北方微电子
528	透明导电膜及其制造方法、太阳能电池及平板显示装置	ZL200810226995.8	2008.11.28	北方微电子
529	载板及连续等离子体镀膜装置	ZL200910086881.2	2009.06.10	北方微电子
530	顶针及具有该顶针的等离子体刻蚀装置	ZL201010219614.0	2010.06.25	北方微电子
531	一种提高电动缸运行精度的方法、装置及电动缸	ZL201010220962.X	2010.06.28	北方微电子
532	静电卡盘和具有它的等离子体装置	ZL201010577917.X	2010.12.02	北方微电子
533	磁控源和磁控溅射设备、以及磁控溅射方法	ZL201010583271.6	2010.12.10	北方微电子
534	工艺数据的获取方法和装置、设备控制系统	ZL201010583993.1	2010.12.10	北方微电子
535	偏移量的生成方法和装置	ZL201010610648.2	2010.12.17	北方微电子
536	偏移量的生成方法和装置	ZL201010610911.8	2010.12.17	北方微电子
537	反应腔装置及具有其的基片处理设备	ZL201110141309.9	2011.05.27	北方微电子
538	CVD 设备和该 CVD 设备的控制方法	ZL201110141318.8	2011.5.27	北方微电子
539	一种卡盘和半导体处理装置	ZL201010547533.3	2010.11.16	北方微电子
540	自动化机台的控制方法、装置及系统	ZL201010593175.X	2010.12.16	北方微电子
541	一种太阳能电池结构及其制备方法	ZL201010218131.9	2010.06.24	北方微电子
542	装卸料机构、CVD 设备和该 CVD 设备的控制方法	ZL201110066938.X	2011.03.18	北方微电子
543	流量比例控制器在线校准方法、系统及等离子体处理设备	ZL200910235889.0	2009.10.28	北方微电子
544	磁控源和磁控溅射设备、以及磁控溅射方法	ZL201010590171.6	2010.12.15	北方微电子
545	基片加热腔室、使用基片加热腔室的方法及基片处理设备	ZL201010606908.9	2010.12.16	北方微电子
546	一种电感耦合线圈及采用该耦合线圈的等	ZL200810057830.2	2008.02.18	北方微电子

	离子体处理设备			
547	静电夹持装置、减少残余电荷的方法及等离子体处理设备	ZL200910243700.2	2009.12.23	北方微电子
548	用于等离子体设备的下电极及等离子体设备	ZL201010274284.5	2010.09.06	北方微电子
549	工艺腔室及应用该工艺腔室的等离子体处理设备	ZL201010282719.0	2010.09.14	北方微电子
550	设备控制软件的帮助系统及其实现方法	ZL201010534560.7	2010.11.03	北方微电子
551	一种反应腔室以及应用该反应腔室的等离子体加工设备	ZL201110424577.1	2011.12.14	北方微电子
552	反应腔装置及具有其的基片处理设备	ZL201110303918.X	2011.09.30	北方微电子
553	下电极机构和具有其的等离子体处理设备	ZL201110427322.0	2011.12.19	北方微电子
554	一种磁控管以及应用该磁控管的磁控溅射设备	ZL201110433434.7	2011.12.21	北方微电子
555	一种控制半导体刻蚀设备的方法	ZL200510126445.5	2005.12.09	北方微电子
556	陶瓷喷涂部件制造方法	ZL200910241612.9	2009.11.27	北方微电子
557	多芯电缆检测装置及检测多芯电缆的方法	ZL200710062685.2	2007.01.12	北方微电子
558	一种气相沉积设备	ZL201010599935.8	2010.12.13	北方微电子
559	屏蔽装置、加工方法及设备、半导体设备	ZL201010588211.3	2010.12.09	北方微电子
560	太阳能电池组件、太阳能电池片的上转换件及其制备方法	ZL201110115927.6	2011.05.05	北方微电子
561	料盒更换装置、插片机和半导体设备	ZL201210261595.7	2012.07.26	北方微电子
562	托盘组件及具有其的 MOCVD 设备	ZL201210286546.9	2012.08.13	北方微电子
563	进气系统、腔室装置和基片处理设备	ZL201110420762.3	2011.12.14	北方微电子
564	工艺腔室装置和具有该工艺腔室装置的基片处理设备	ZL201110116006.1	2011.05.05	北方微电子
565	反应腔室以及薄膜沉积设备	ZL201210210297.5	2012.06.25	北方微电子
566	半导体工艺监测方法和半导体工艺监测装置	ZL201110453589.7	2011.12.29	北方微电子

二、国内实用新型专利（45项）

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利权人
1	等离子体刻蚀设备	ZL201220224678.4	2012.05.17	北方微电子
2	防腐防沉积的真空管道和具有它的微电子设备	ZL201220214877.7	2012.05.14	北方微电子
3	预清洗工艺腔室	ZL201220282730.1	2012.06.15	北方微电子
4	一种匹配器及等离子体加工设备	ZL201220524313.3	2012.10.12	北方微电子
5	机械手装置和装卸载系统	ZL201220569790.1	2012.11.01	北方微电子
6	加热腔室以及半导体加工设备	ZL201320891017.1	2013.12.31	北方微电子
7	PCB 板卡固定装置及 PCB 板卡	ZL200820123586.0	2008.11.13	北方微电子
8	基片缓冲器及半导体加工设备	ZL200820124223.9	2008.12.02	北方微电子
9	晶圆承载料盒及半导体加工设备	ZL200920105579.2	2009.02.26	北方微电子
10	网络交换机保护装置及半导体加工控制系统	ZL200920106507.X	2009.03.13	北方微电子
11	一种用于集成电路加工设备的晶片载台和反应腔室	ZL200920246446.7	2009.10.23	北方微电子
12	一种内衬及应用该内衬的等离子装置	ZL200920246343.0	2009.09.30	北方微电子
13	一种双输出匹配器及一种等离子体发生装置	ZL200920278357.0	2009.12.21	北方微电子
14	一种 PECVD 设备	ZL201020215854.9	2010.05.26	北方微电子
15	大气传输单元及具有该大气传输单元的晶片传输系统	ZL201020538674.4	2010.09.20	北方微电子
16	刻蚀机及其开盖装置	ZL201020612990.1	2010.11.17	北方微电子
17	驱动器连接部件和具有它的压环升降机构	ZL201020613658.7	2010.11.18	北方微电子
18	传输系统以及包含该传输系统的等离子体加工设备	ZL201020631224.X	2010.11.24	北方微电子
19	线圈连接组件，上电极装置和 LED 刻蚀机	ZL201020602912.3	2010.11.11	北方微电子
20	电镀装置	ZL201120122439.3	2011.04.22	北方微电子
21	吹扫装置和具有它的等离子体增强化学气相沉积设备	ZL201120173291.6	2011.05.26	北方微电子

22	一种传动设备和载板	ZL201120203644.2	2011.06.16	北方微电子
23	一种半导体加工设备	ZL201120195588.2	2011.06.10	北方微电子
24	一种反应腔室及应用该反应腔室的等离子体加工设备	ZL201120278957.4	2011.08.02	北方微电子
25	料盒传输系统	ZL201120268717.6	2011.07.27	北方微电子
26	一种装载装置及应用该装载装置的等离子体加工设备	ZL201120354206.6	2011.09.20	北方微电子
27	一种温度监控装置及等离子体加工设备	ZL201120395484.6	2011.10.18	北方微电子
28	一种气相沉积设备	ZL201120351150.9	2011.09.19	北方微电子
29	气体分配装置及等离子体加工设备	ZL201120446208.8	2011.11.11	北方微电子
30	托盘组件和刻蚀设备	ZL201420467560.3	2014.08.19	北方微电子
31	一种压环	ZL201420674496.6	2014.11.06	北方微电子
32	一种线圈固定结构	ZL201420675838.6	2014.11.06	北方微电子
33	密封圈	ZL201520089078.5	2015.02.09	北方微电子
34	一种溅射工艺反应腔的内衬结构	ZL201520094946.9	2015.02.10	北方微电子
35	一种静电卡盘系统	ZL201520103626.5	2015.02.12	北方微电子
36	静电卡盘	ZL201320421139.4	2013.07.16	北方微电子
37	升针机构和升降装置	ZL201320422723.1	2013.07.16	北方微电子
38	密封结构、反应腔室和半导体处理设备	ZL201320425745.3	2013.07.17	北方微电子
39	基底固定组件	ZL201120104130.1	2011.04.11	北方微电子
40	托盘组件和具有该托盘组件的基片处理设备	ZL201120140728.6	2011.05.05	北方微电子
41	基底支撑组件	ZL201120107777.X	2011.04.13	北方微电子
42	密封圈及应用该密封圈的等离子体加工设备	ZL201120096149.6	2011.04.02	北方微电子
43	加热基座	ZL201520248548.8	2015.04.23	北方微电子
44	卡环、承载装置及半导体加工设备	ZL201520377875.3	2015.06.03	北方微电子
45	一种托盘	ZL201520411273.5	2015.06.15	北方微电子

三、国际专利（55项）

序号	专利名称	专利号	专利申请日	申请地
1	一种静电卡盘及其残余电荷的消除方法	SG180354	2010.08.19	新加坡
2	均热板及应用该均热板的基片处理设备	SG191024	2011.11.23	新加坡
3	氧化铟锡薄膜溅镀方法及氧化铟锡薄膜溅镀设备	TW I496915	2013.12.25	台湾
4	金属有机化学气相沉积设备及其腔室组件	TW I489585	2011.12.20	台湾
5	反应腔和 MOCVD 设备	TW I486484	2013.12.10	台湾
6	托盘装置、反应腔室和金属有机化合物化学气相沉积（MOCVD）设备	TW I486480	2013.11.14	台湾
7	基片处理设备	TW I484587	2011.12.13	台湾
8	均热板及应用该均热板的基片处理设备	KR10-1510577	2013.07.01	韩国
9	物理气相沉积装置	TW I480405	2013.11.26	台湾
10	均热板及应用该均热板的基片处理设备	TW I468637	2011.12.02	台湾
11	等离子体处理设备及其气体分配装置	US8,888,949B2	2009.01.09	美国
12	等离子体加工设备	KR10-1456810	2013.04.24	韩国
13	基片刻蚀方法及基片处理设备	TW I458015	2012.07.17	台湾
14	磁控管、磁控管的制造方法及应用上述磁控管的物理沉积室	TWI450310	2012.04.02	台湾
15	晶圆承载装置及具有它的半导体处理设备	TW I449115	2012.08.03	台湾
16	靶材功率载入方法、靶材电源及半导体处理设备	TWI449114	2011.09.20	台湾
17	磁控源，磁控溅射设备和磁控溅射方法	SG191806	2011.09.30	新加坡
18	溅射腔室、预清洗腔室以及等离子体加工设备	TW I436407	2011.04.20	台湾
19	进气环、进气组件、工艺腔装置和 CVD 设备	SG194576	2011.09.20	新加坡
20	深硅刻蚀装置和深硅刻蚀设备的进气系统	KR10-1322545	2012.03.26	韩国
21	等离子体加工设备	US8,547,021B2	2009.08.20	美国
22	电感耦合线圈及采用该电感耦合线圈的电感耦合等离子体装置	JP5315243	2007.01.26	日本
23	等离子体处理设备	SG169732	2009.09.03	新加坡
24	一种靶材功率加载方法、靶材电源及半导体处理设备	SG175435	2010.12.17	新加坡
25	等离子体处理设备及其气体分配装置	JP5184649	2009.01.09	日本

26	等离子体处理设备	KR10-1203619	2011.04.12	韩国
27	等离子体加工设备	SG171466	2009.10.20	新加坡
28	电感耦合线圈及电感耦合等离子体装置	TW I368462	2007.08.13	台湾
29	一种控制射频放电系统直流偏压的装置和方法	US8,217,579B2	2008.02.03	美国
30	一种在线预测设备维护的方法	US8,154,721B2	2007.09.05	美国
31	电感耦合线圈及采用该电感耦合线圈的等离子体装置	SG173346	2007.08.14	新加坡
32	电感耦合线圈及采用该电感耦合线圈的电感耦合等离子体装置	KR10-1104571	2011.05.11	韩国
33	等离子体处理装置	SG162530	2008.12.31	新加坡
34	电感耦合线圈及采用该电感耦合线圈的等离子体装置	KR10-1068746	2009.01.23	韩国
35	电感耦合线圈及采用该电感耦合线圈的电感耦合等离子体装置	KR10-1048245	2009.02.04	韩国
36	一种控制射频放电系统直流偏压的装置和方法	SG162144	2008.02.03	新加坡
37	半导体处理设备	SG160413	2007.02.14	新加坡
38	等离子体处理设备及其气体分配装置	SG162576	2009.01.09	新加坡
39	控温装置及其控制晶片温度的方法	TW I340988	2007.08.13	台湾
40	半导体处理设备	SG150168	2007.02.14	新加坡
41	腔室组件和包含其之金属有机化合物化学气相沉积设备	TW I503869	2011.12.06	台湾
42	等离子体加工设备	SG189129	2010.12.22	新加坡
43	热反射装置及半导体处理设备	SG195265	2011.11.18	新加坡
44	基片刻蚀方法及基片处理设备	SG11201404015T	2012.06.04	新加坡
45	基片刻蚀方法及基片处理设备	US9,187,319B2	2012.06.04	美国
46	基片刻蚀方法	TW I506692	2013.10.25	台湾
47	晶圆承载装置及具有它的半导体处理设备	SG11201401955Y	2012.05.17	新加坡
48	基片处理设备及其腔室装置	TW I512128	2012.08.03	台湾
49	加热腔室及电浆加工装置	TW I510655	2013.12.16	台湾
50	深硅蚀刻方法	TW I514470	2013.11.27	台湾

51	一种衬底处理系统	TW I510662	2013.11.19	台湾
52	ITO 薄膜溅镀加工方法及 ITO 薄膜溅镀设备	TW I510661	2013.12.25	台湾
53	制程腔室以及半导体加工装置	TWI513838	2014.12.22	台湾
54	深硅刻蚀装置和深硅刻蚀设备的进气系统	SG10201501149P	2010.08.19	新加坡
55	基片刻蚀方法	SG11201503933R	2013.11.01	新加坡

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》签字页）

北京金诚同达律师事务所

负 责 人（签字）

经办律师（签字）

贺宝银： _____

赵力峰： _____

贺 维： _____

2016年2月3日